

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

西门康外型

SKKT100/16E

chunshu rectifier co., Ltd.

特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{T(AV)}$	100A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	1000A
I_{T^2t}	$1.5A^2S \cdot 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			100	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			110	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			10	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			10	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I_{T^2t}	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$	125			550	$A^2s \cdot 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			9	V
r_T	斜率电阻		125			12	m Ω
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=480A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			1000	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=320A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$ 门极上升时间 $t_{ir} \leq 0.5 \mu s$	125			150	A/ μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	3		150	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	100		200	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	25			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图

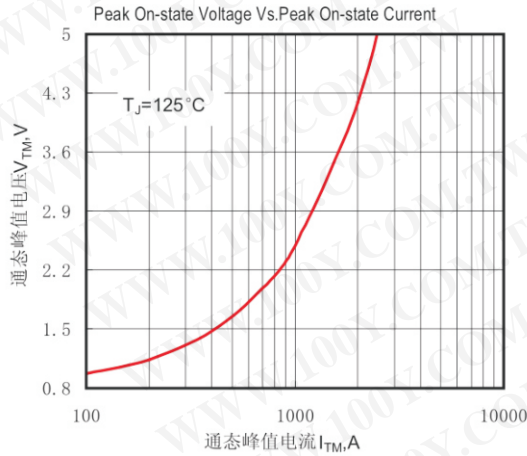


Fig.1 通态伏安特性曲线

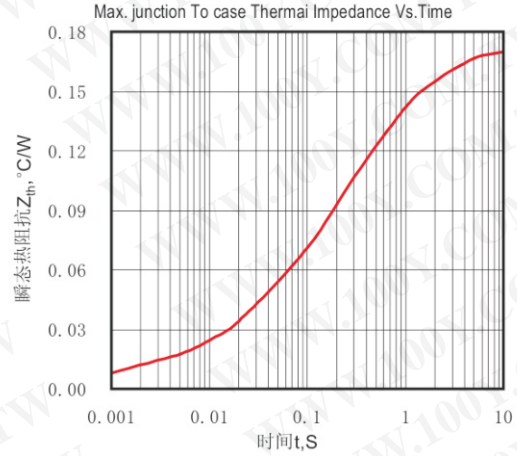


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

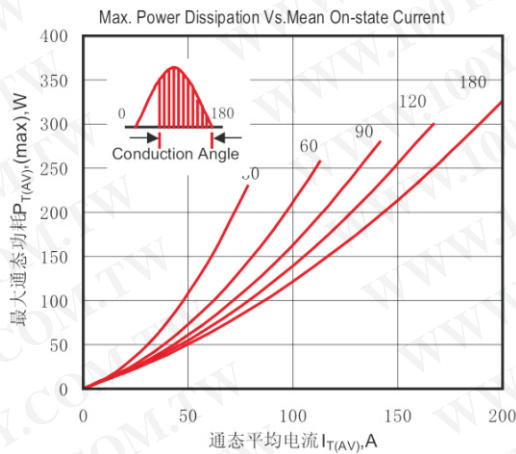


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

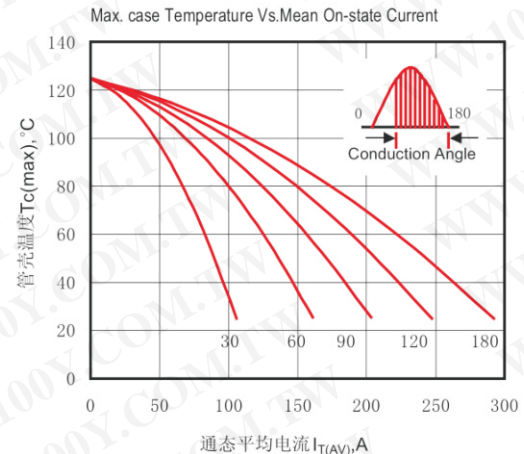


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

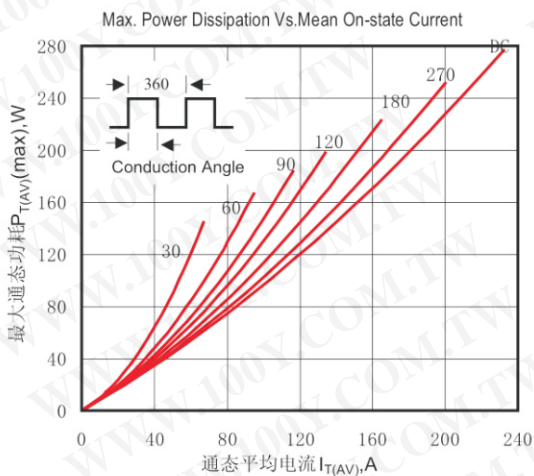


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

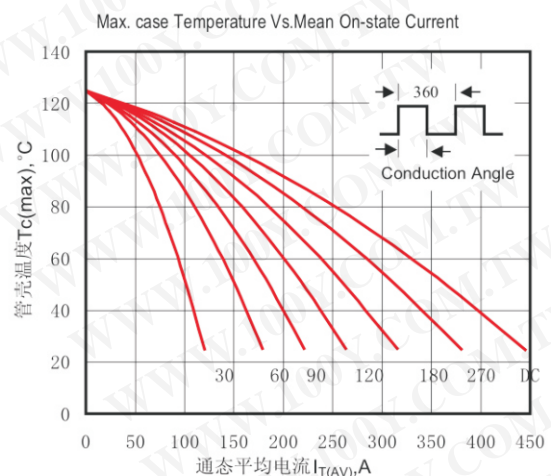


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

西门康外型

SKKT100/16E

chunshu rectifier co., Ltd.

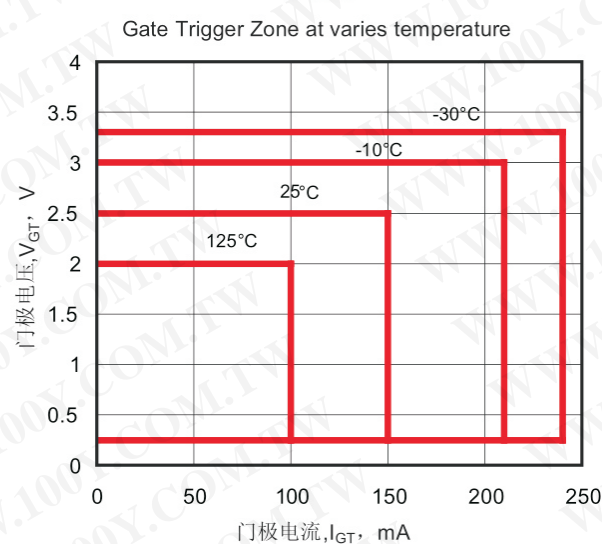
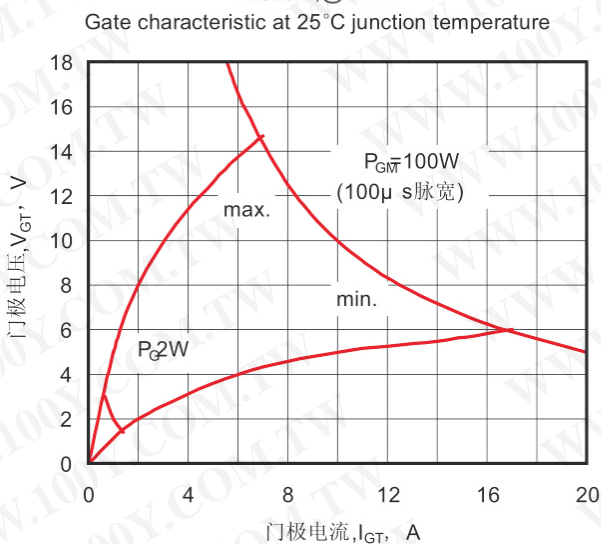
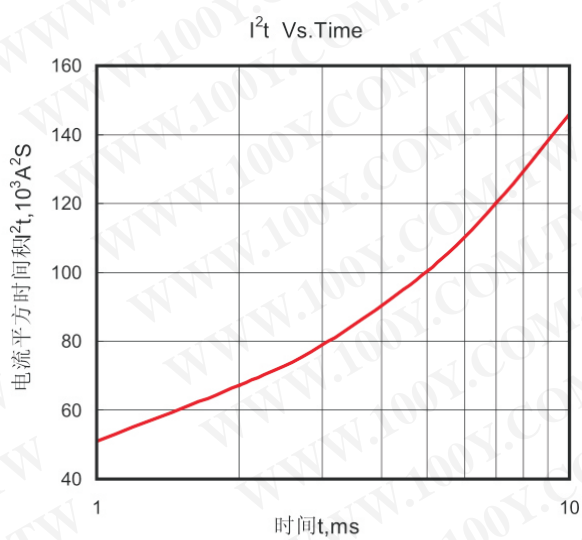
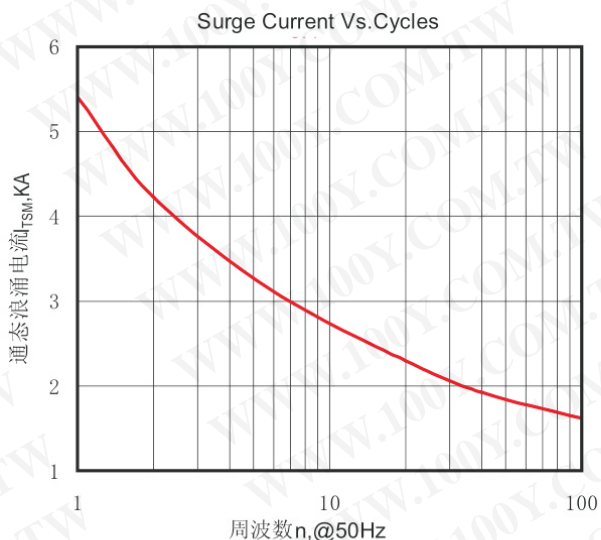
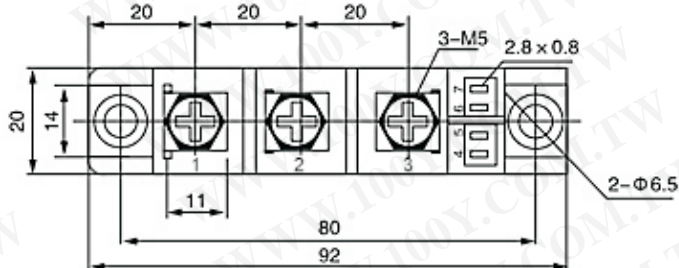
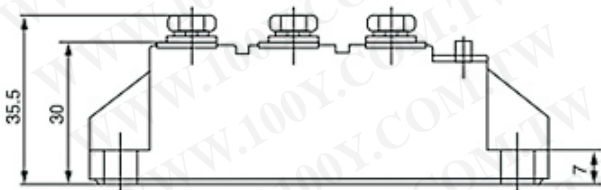


Fig.9 门极功率曲线

Fig.10 门极触发特性曲线

外形尺寸图



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

西门康外型

SKKT106/16E

chunshu rectifier co., Ltd.

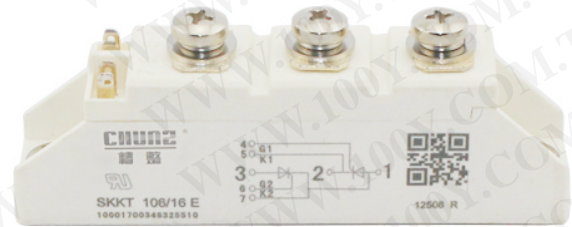
特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{T(AV)}$	106A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	1000A
I_{T^2t}	$1.5A^2S \cdot 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			106	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			110	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			10	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			10	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I_{T^2t}	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$	125			550	$A^2s \cdot 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			9	V
r_T	斜率电阻		125			12	m Ω
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=480A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			1000	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=320A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$ 门极上升时间 $t_{ir} \leq 0.5 \mu s$	125			150	A/ μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	3		150	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	100		200	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	25			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图

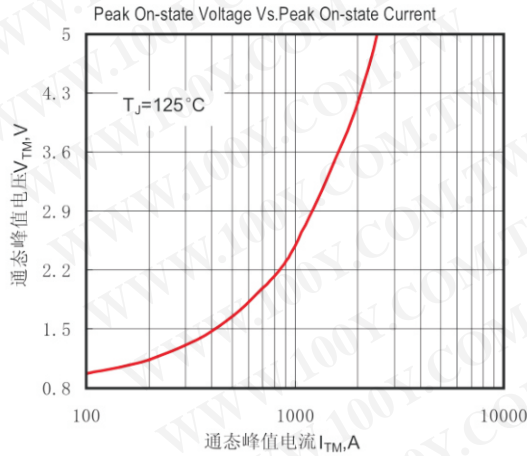


Fig.1 通态伏安特性曲线

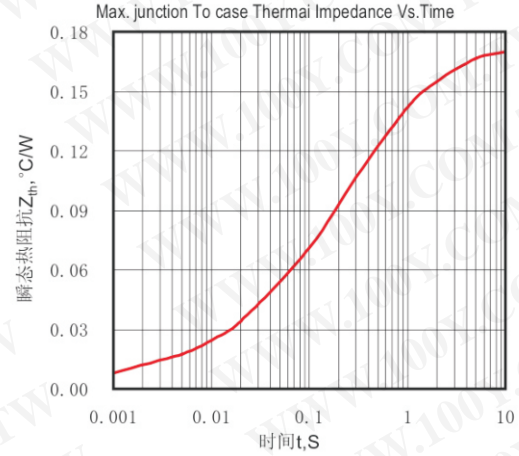


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

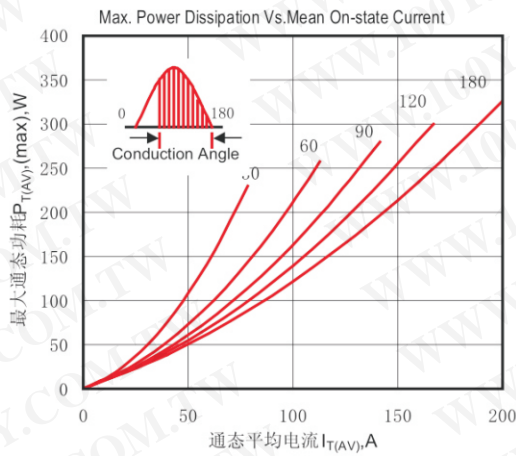


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

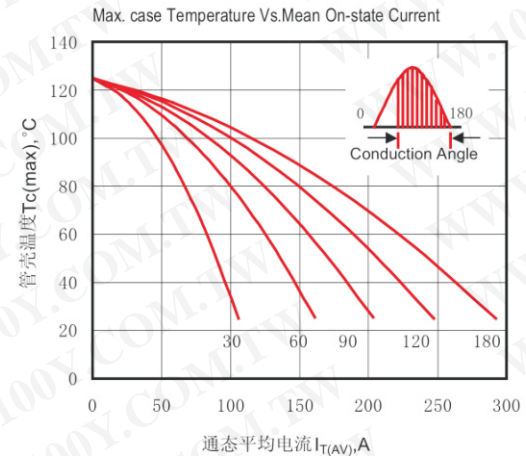


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

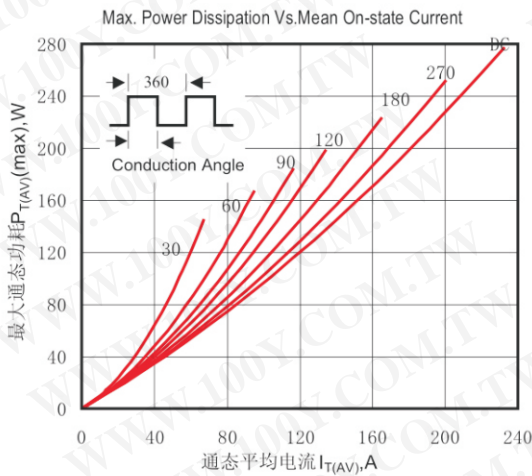


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

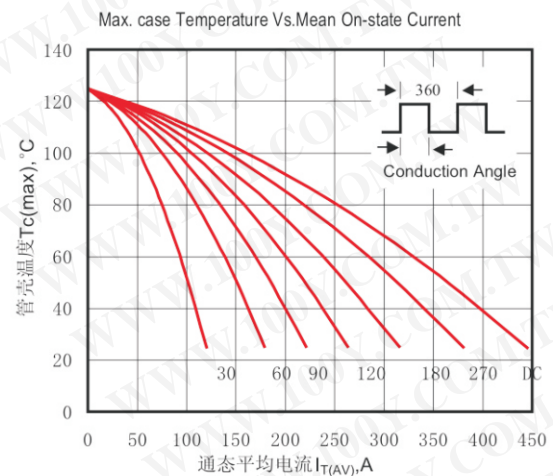


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

西门康外型

SKKT106/16E

chunshu rectifier co., Ltd.

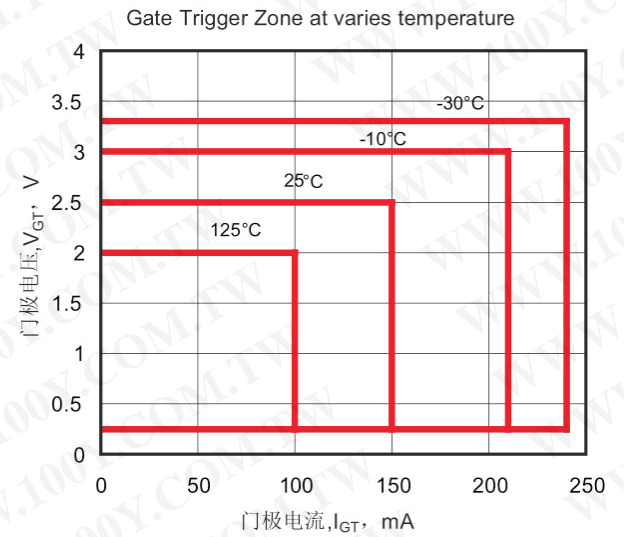
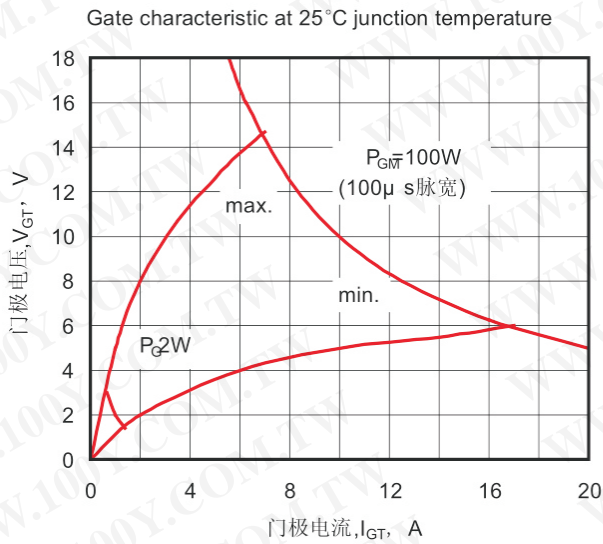
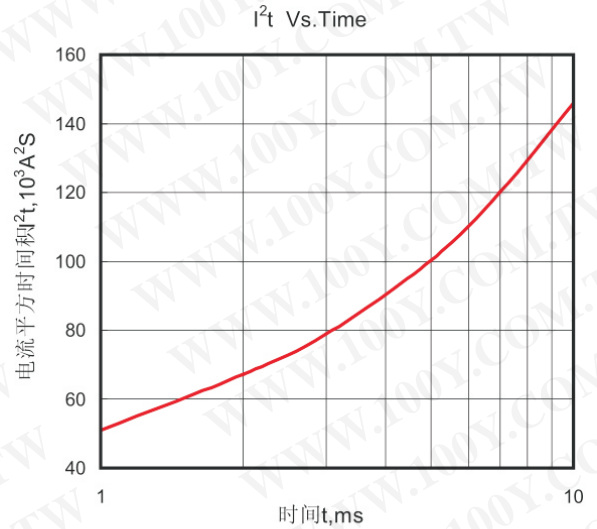
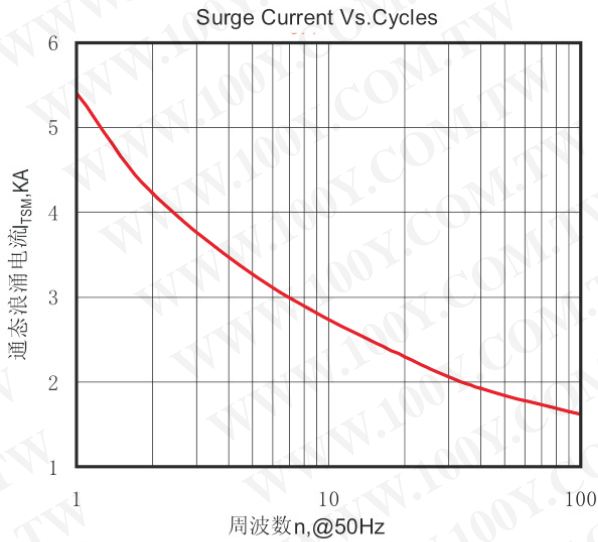
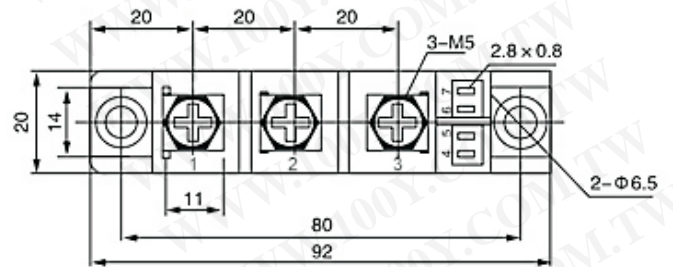
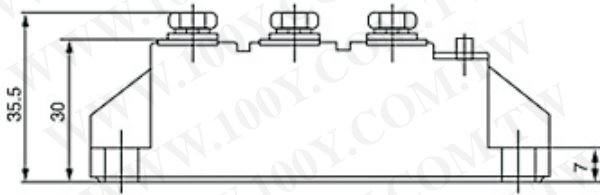


Fig.9 门极功率曲线

Fig.10 门极触发特性曲线

外形尺寸图



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

西门康外型

SKKT27/16E

chunshu rectifier co., Ltd.

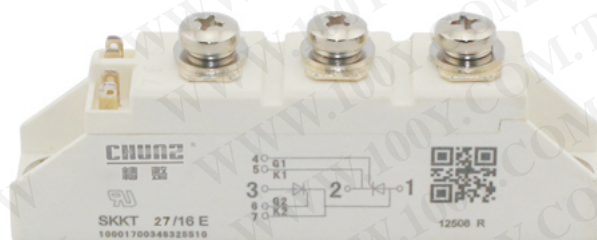
特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{T(AV)}$	27A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	1000A
I_{T^2t}	$1.5A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			27	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			110	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			10	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			10	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I_{T^2t}	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$	125			550	$A^2s \times 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			9	V
r_T	斜率电阻		125			12	m Ω
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=480A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			1000	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=320A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$ 门极上升时间 $t_{ir} \leq 0.5 \mu s$	125			150	A/ μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	3		150	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	100		200	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	25			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图

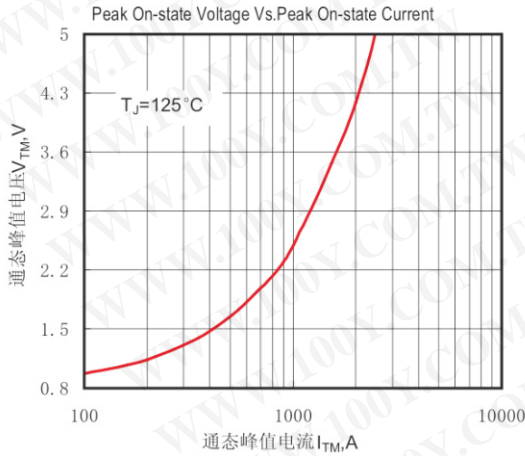


Fig.1 通态伏安特性曲线

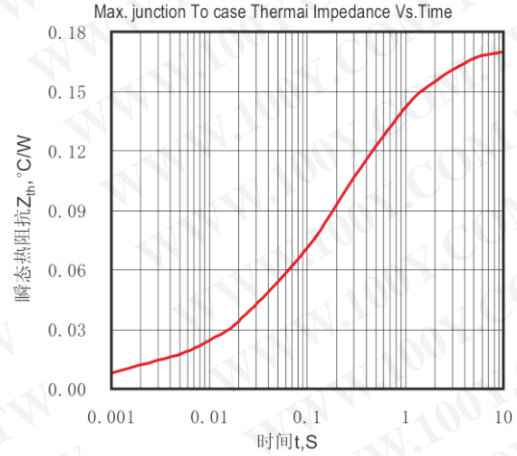


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

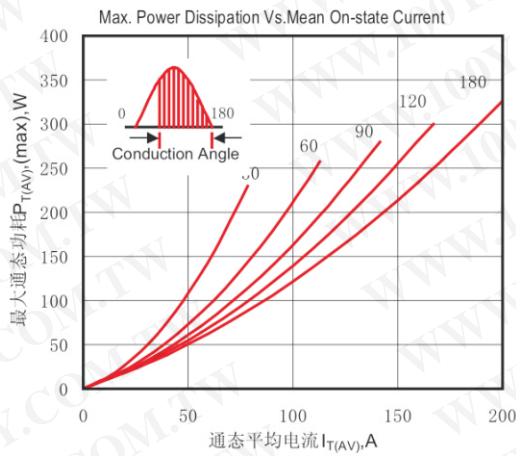


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

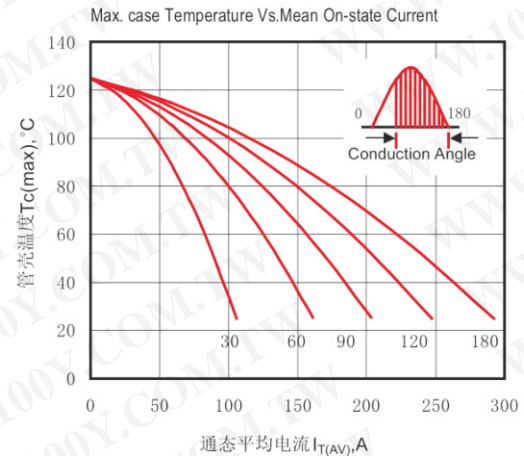


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

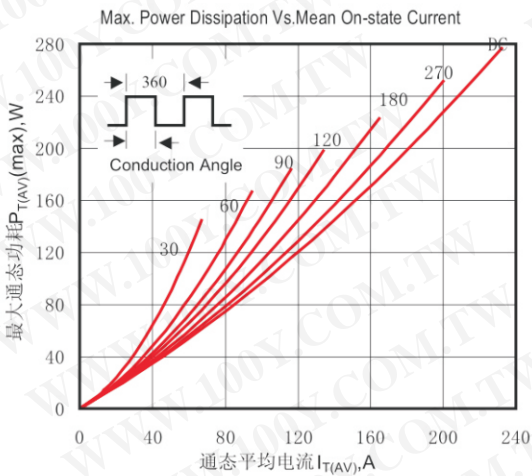


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

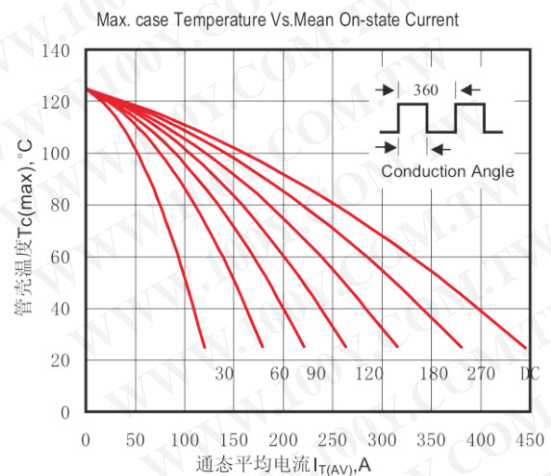


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

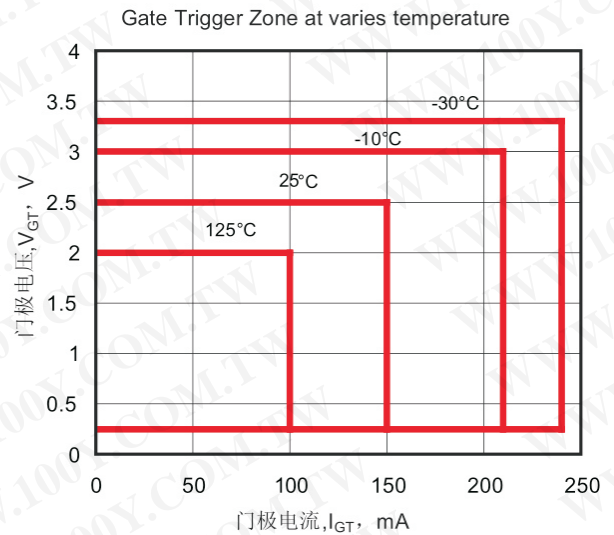
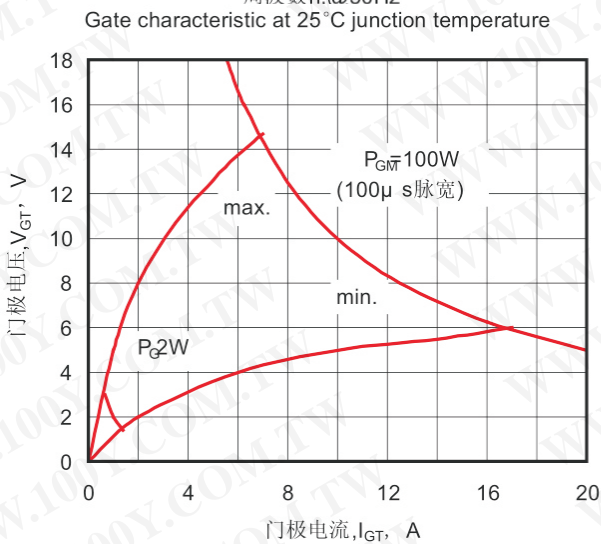
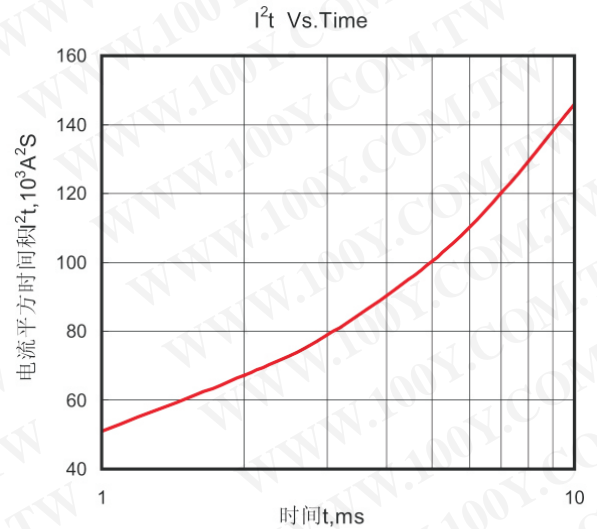
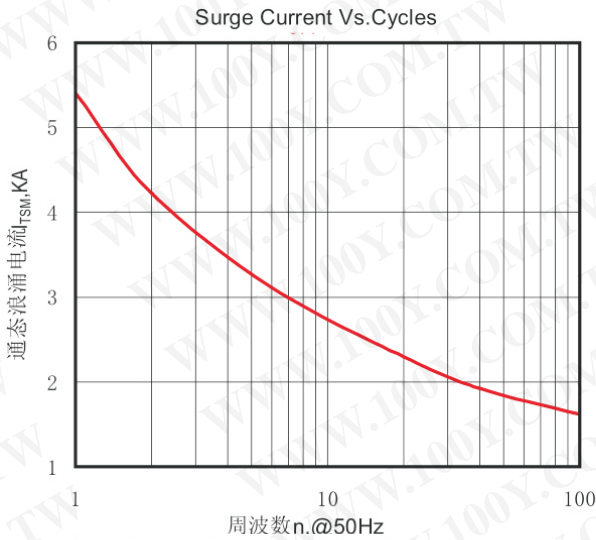
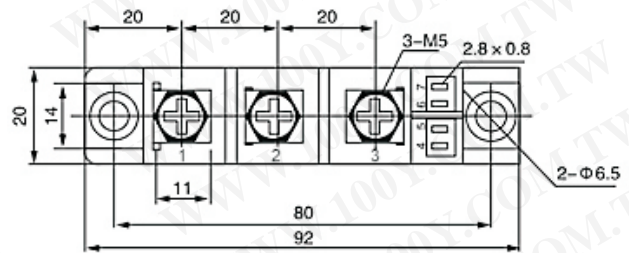
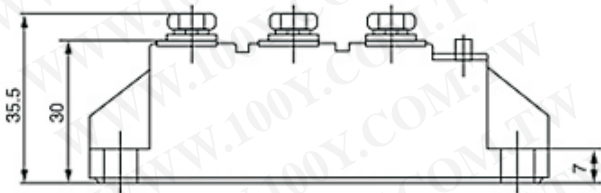


Fig.9 门极功率曲线

Fig.10 门极触发特性曲线

外形尺寸图



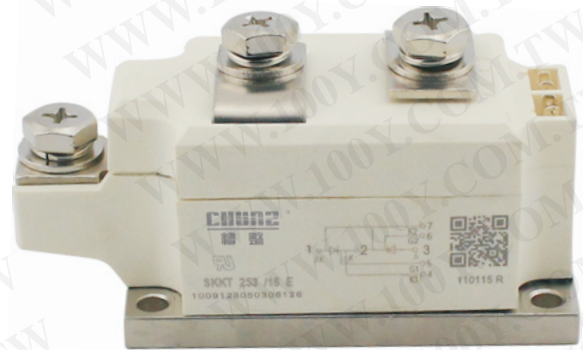
特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

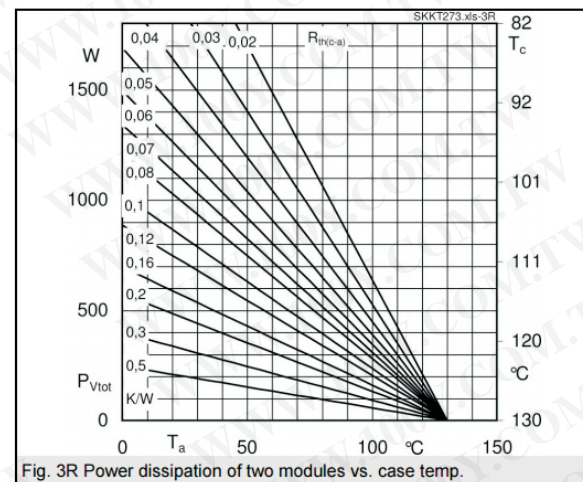
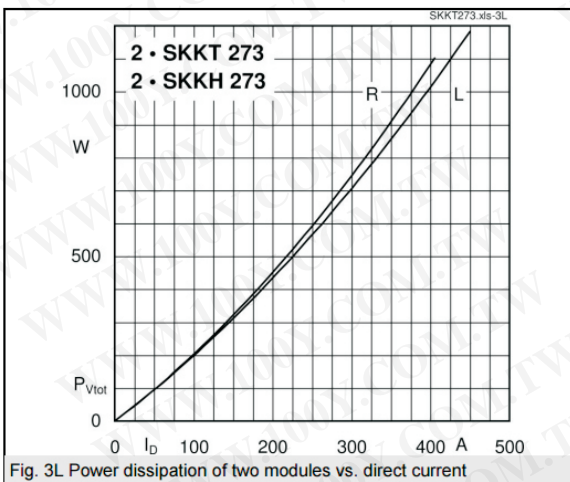
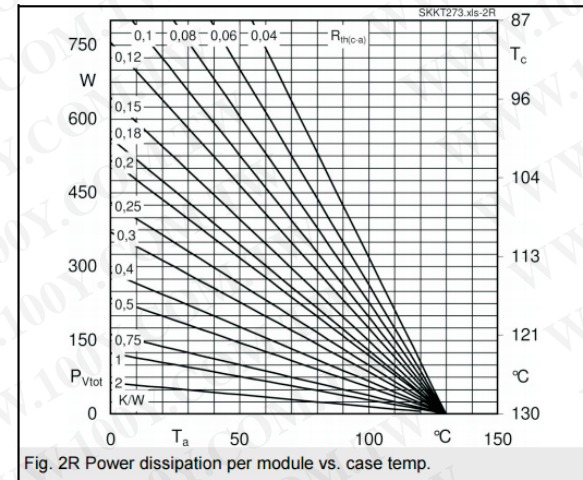
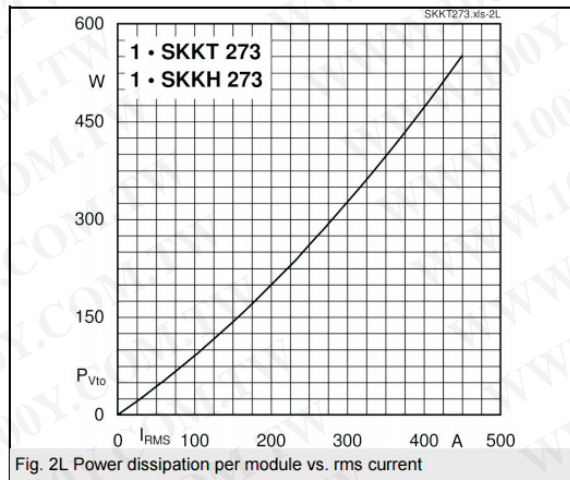
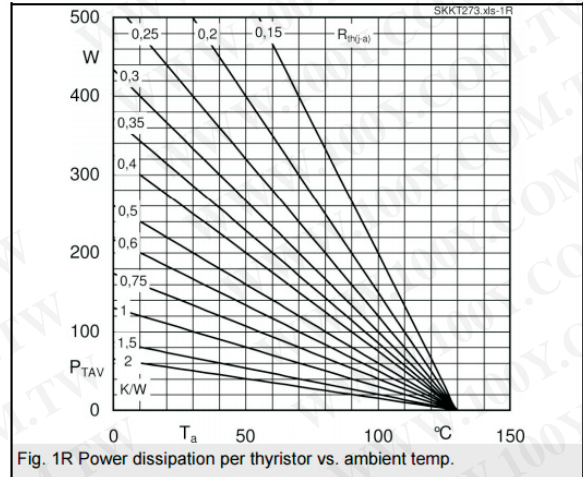
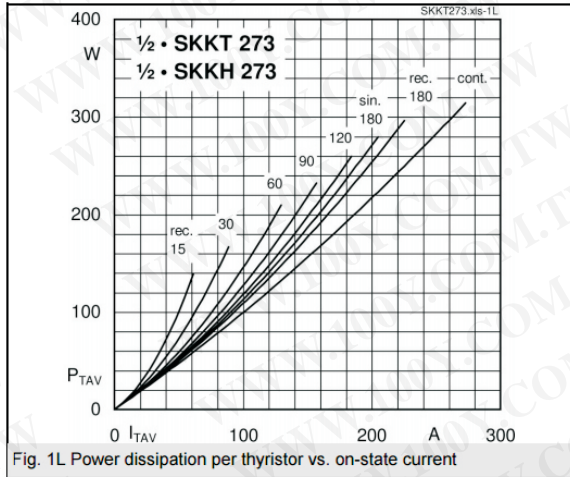
$I_{T(AV)}$	273A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	$8.5A \times 10^3$
I^2t	$360A^2S \times 10^3$

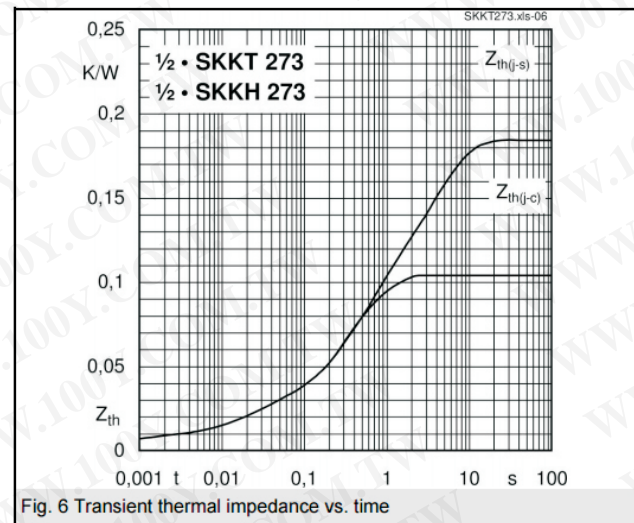
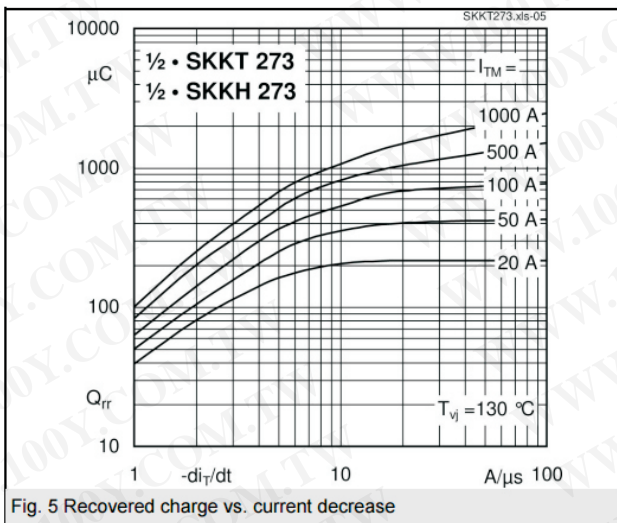
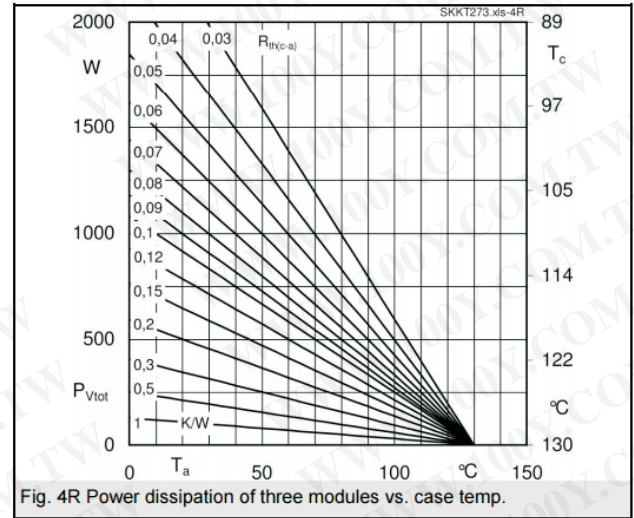
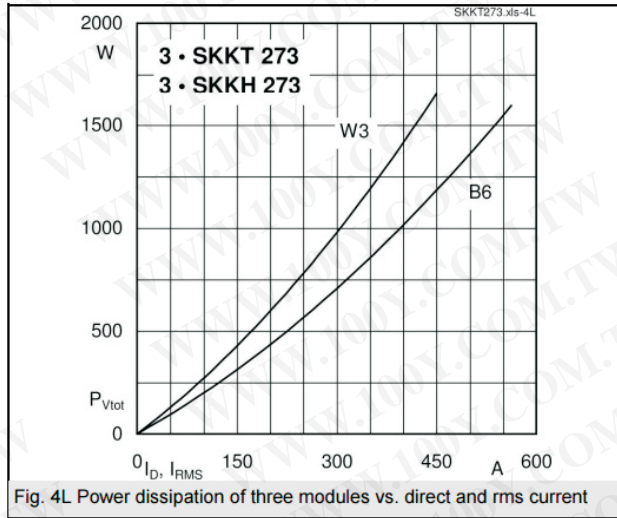


主要参数

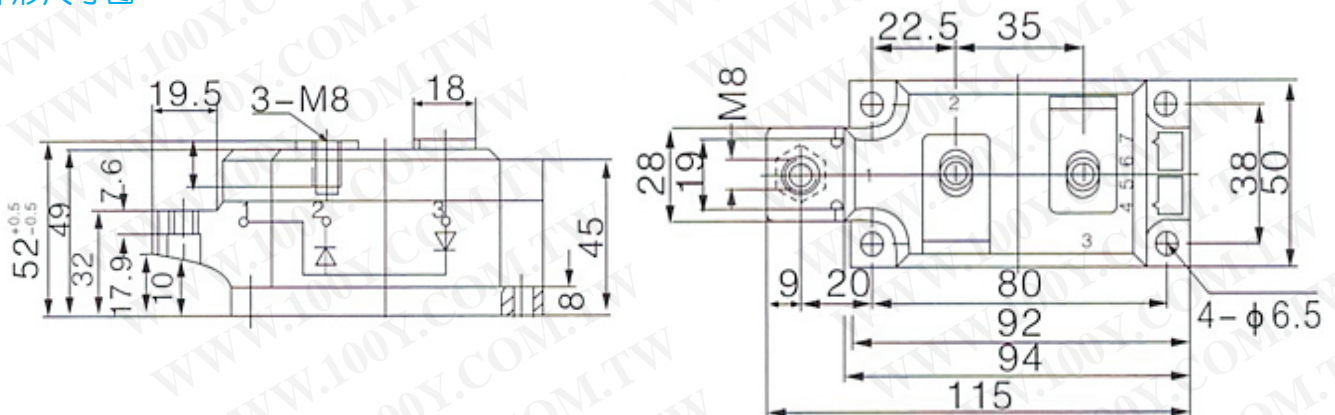
符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			273	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			393	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125	1600			V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125	1600			V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			30	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			30	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_r=0.6V_{RRM}$	125			360	$A^2s \times 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			0.80	V
r_T	斜率电阻		125			0.85	m Ω
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=750A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			800	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=500A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$, 门极上升时间 $t_r \leq 0.5 \mu s$	125			100	A/ μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	30		100	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图





外形尺寸图



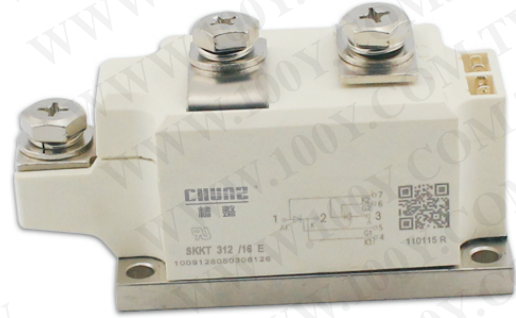
特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

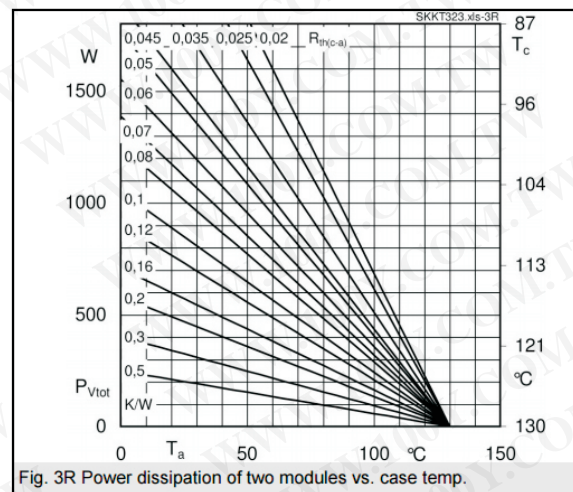
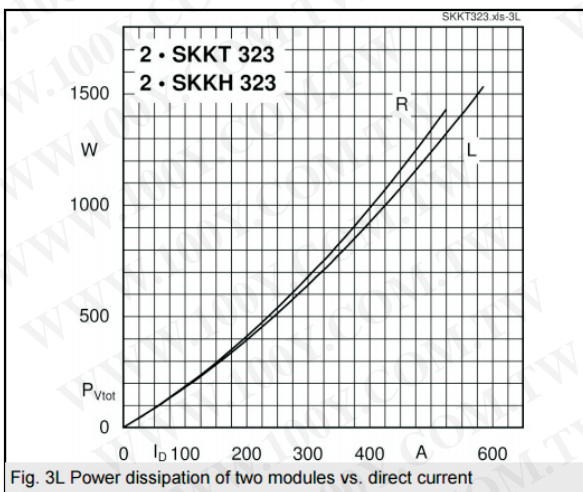
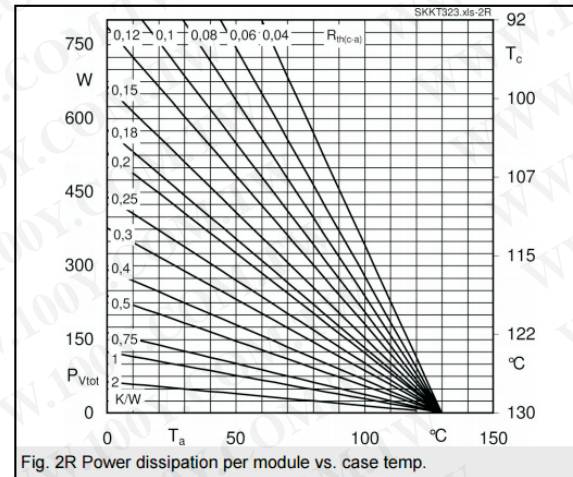
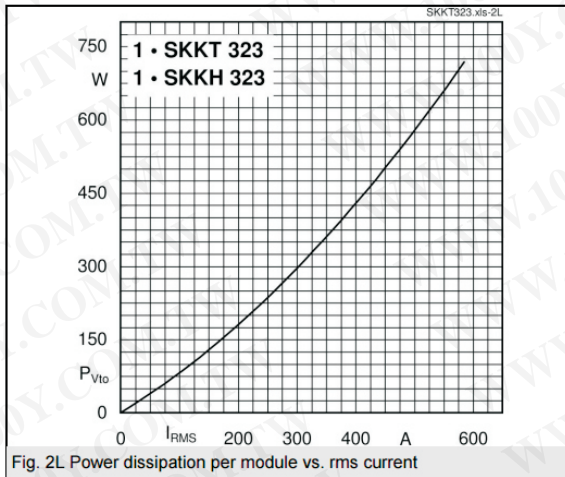
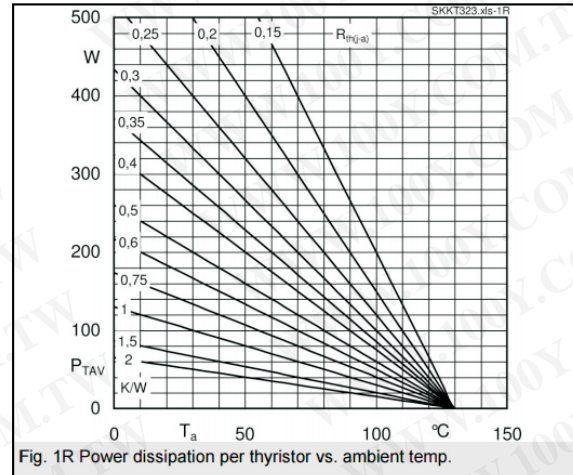
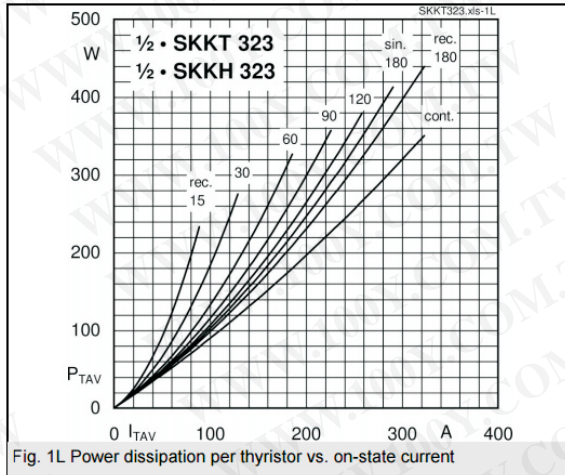
$I_{T(AV)}$	312A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	$8.5A \times 10^3$
I^2t	$360A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^\circ C$	$T_j(^\circ C)$				A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			312	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			30	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			30	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_r=0.6V_{RRM}$	125			360	$A^2s \times 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			0.80	V
r_T	斜率电阻		125			0.85	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=750A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			800	$V/\mu s$
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=500A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$, 门极上升时间 $t_r \leq 0.5 \mu s$	125			100	$A/\mu s$
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	30		100	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^\circ C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^\circ C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图



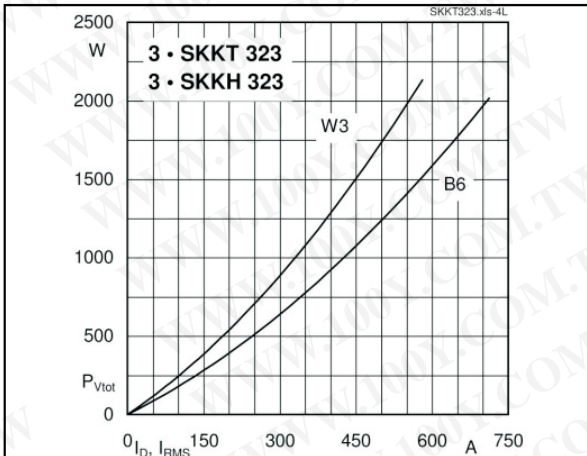


Fig. 4L Power dissipation of three modules vs. direct and rms current

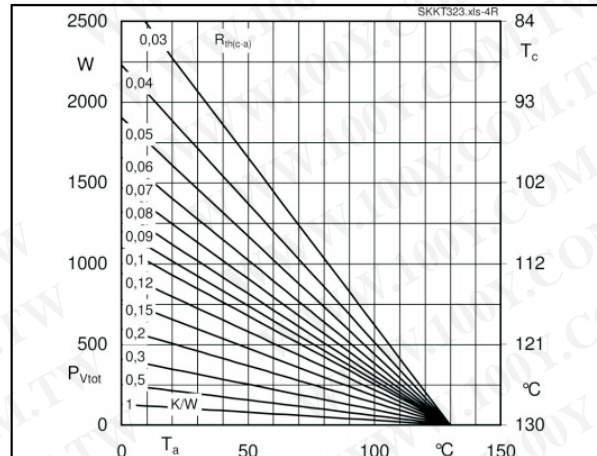


Fig. 4R Power dissipation of three modules vs. case temp.

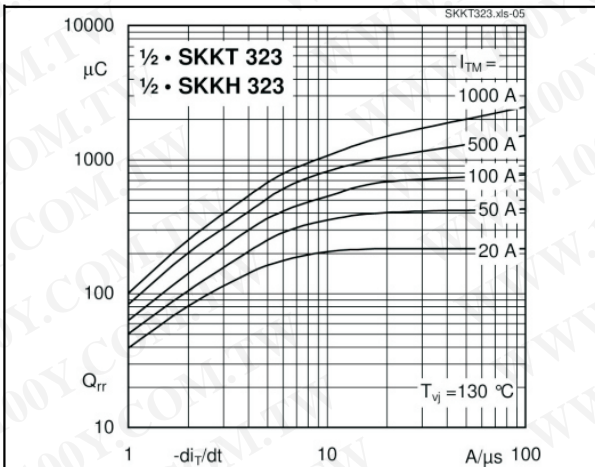


Fig. 5 Recovered charge vs. current decrease

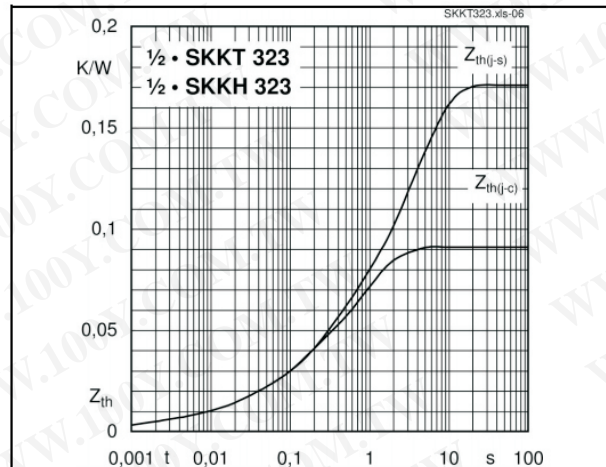
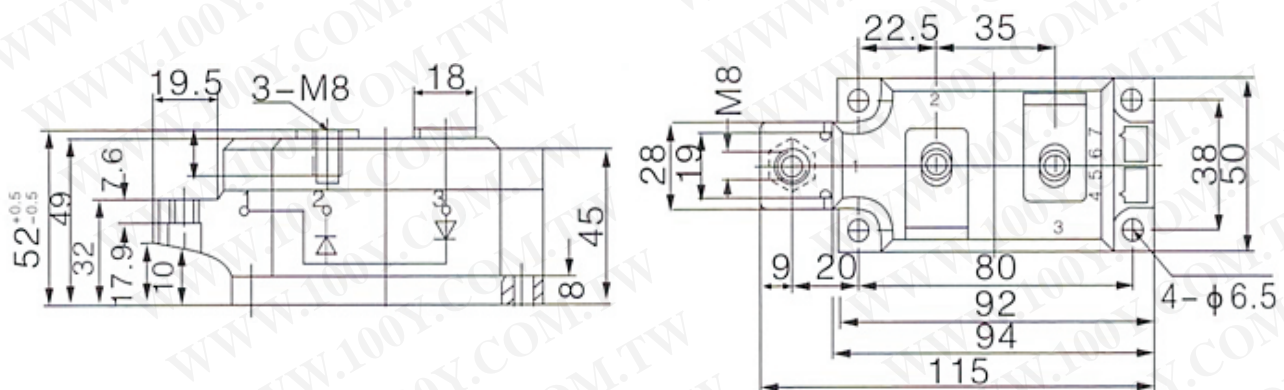


Fig. 6 Transient thermal impedance vs. time

外形尺寸图

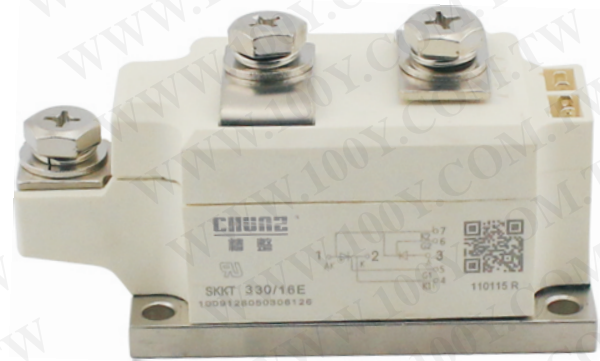


特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

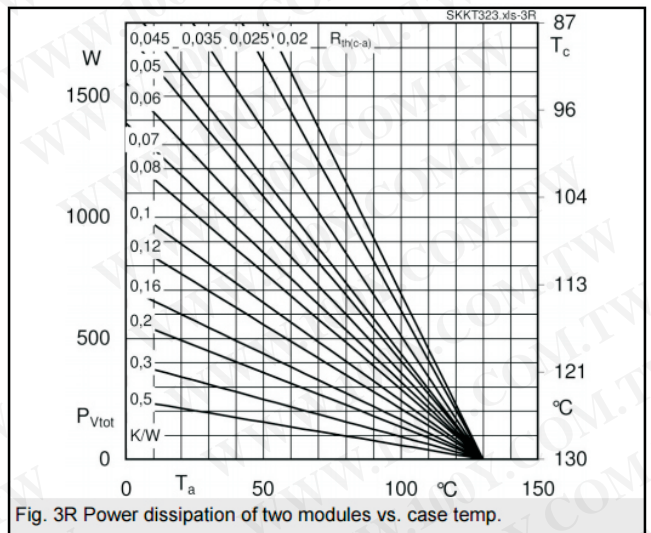
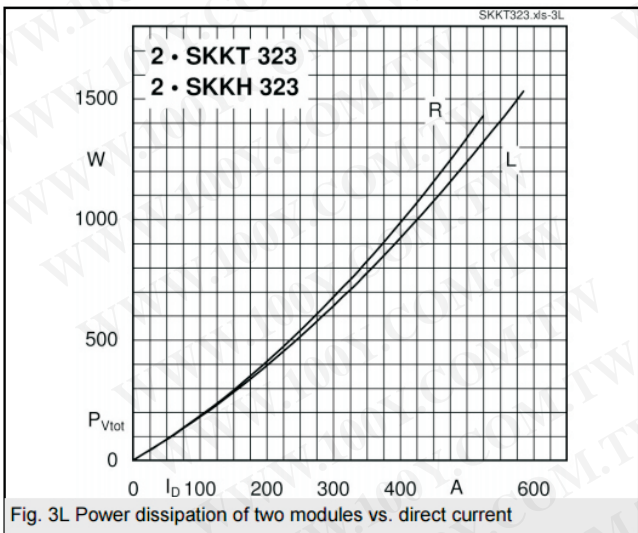
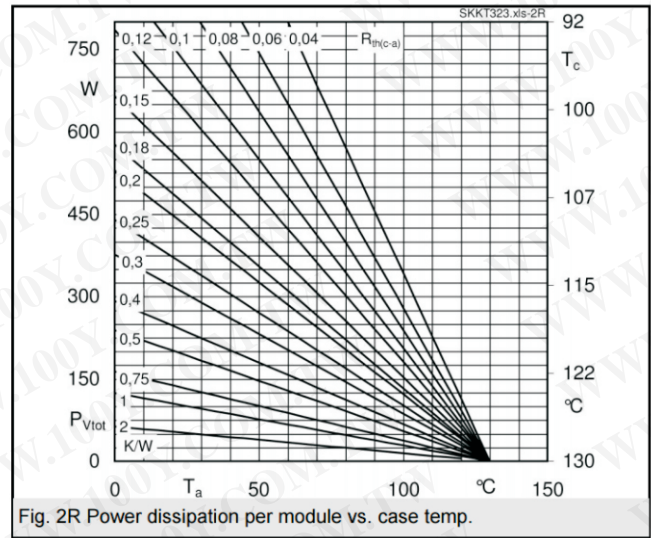
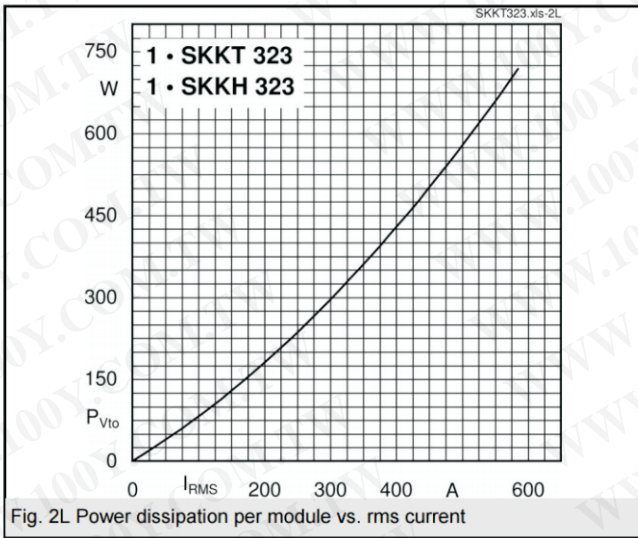
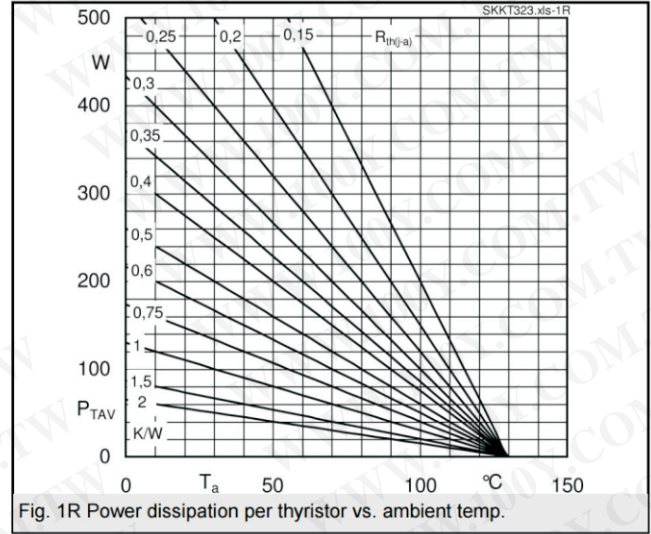
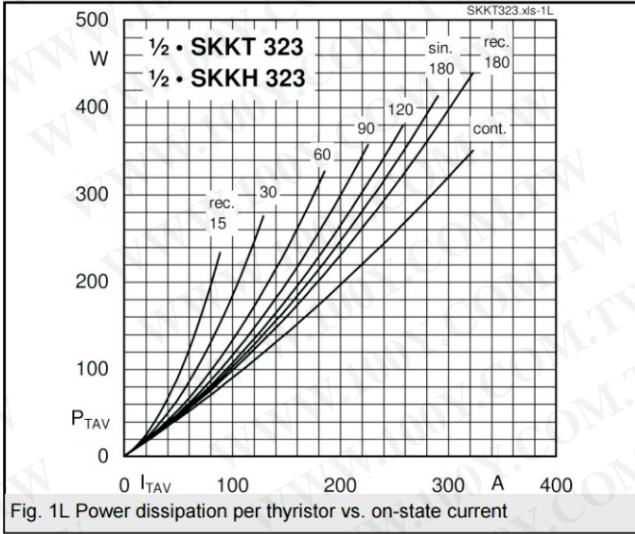
- | | | |
|------------|-------------------|-----------------------|
| 1. 交直流电机控制 | $I_{T(AV)}$ | 330A |
| 2. 各种整流电源 | V_{DRM}/V_{RRM} | 1600V |
| 3. 变频器 | I_{TSM} | $8.5A \times 10^3$ |
| | I_{Tt} | $360A^2s \times 10^3$ |



主要参数

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			330	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			393	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125	1600			V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125	1600			V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			30	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			30	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I_{Tt}	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$	125			360	$A^2s \times 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			0.80	V
r_T	斜率电阻		125			0.85	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=750A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			800	V/μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=500A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$ 门极上升时间 $t_r \leq 0.5 \mu s$	125			100	A/μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	30		100	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性



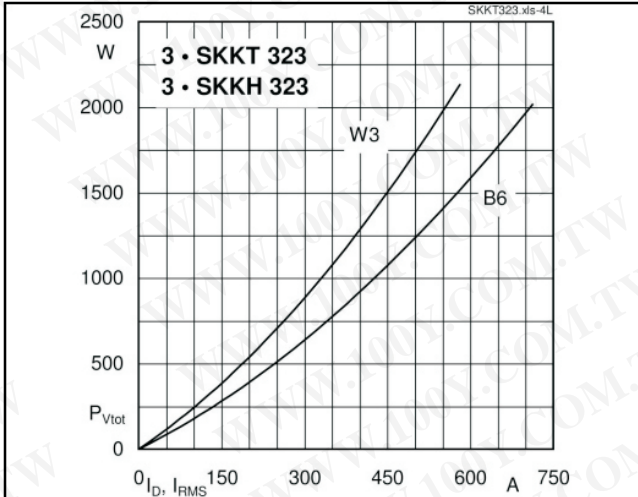


Fig. 4L Power dissipation of three modules vs. direct and rms current

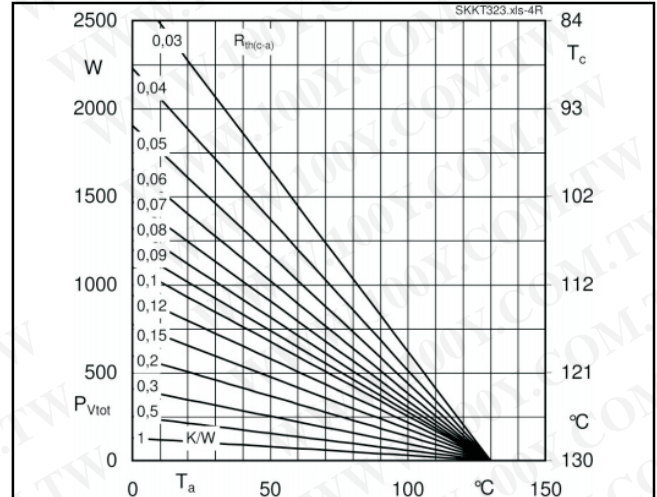


Fig. 4R Power dissipation of three modules vs. case temp.

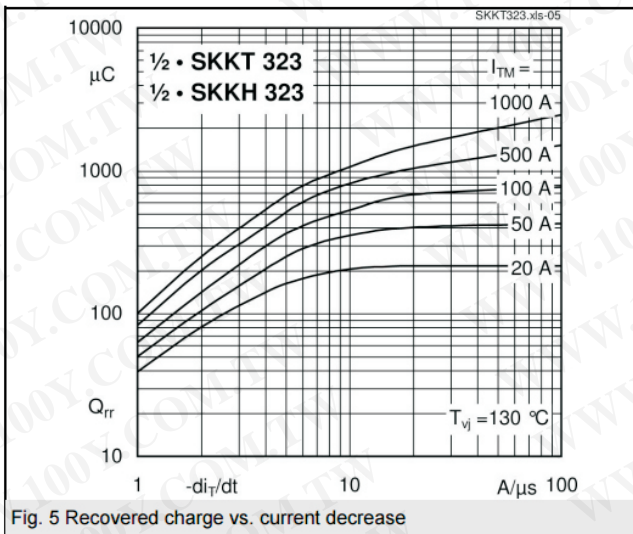


Fig. 5 Recovered charge vs. current decrease

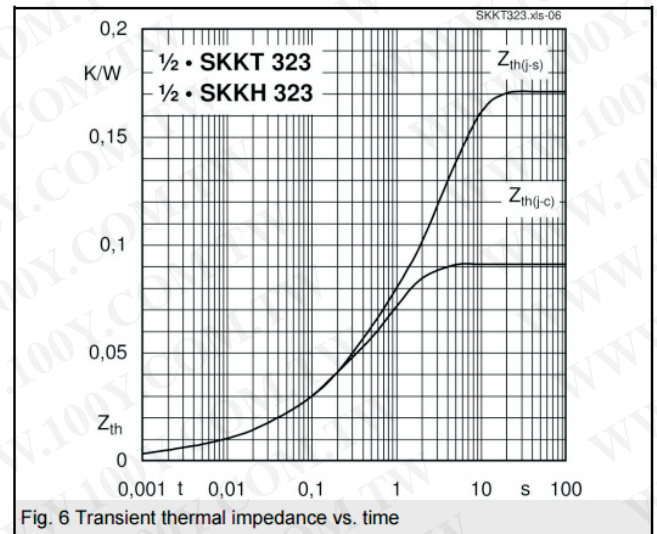
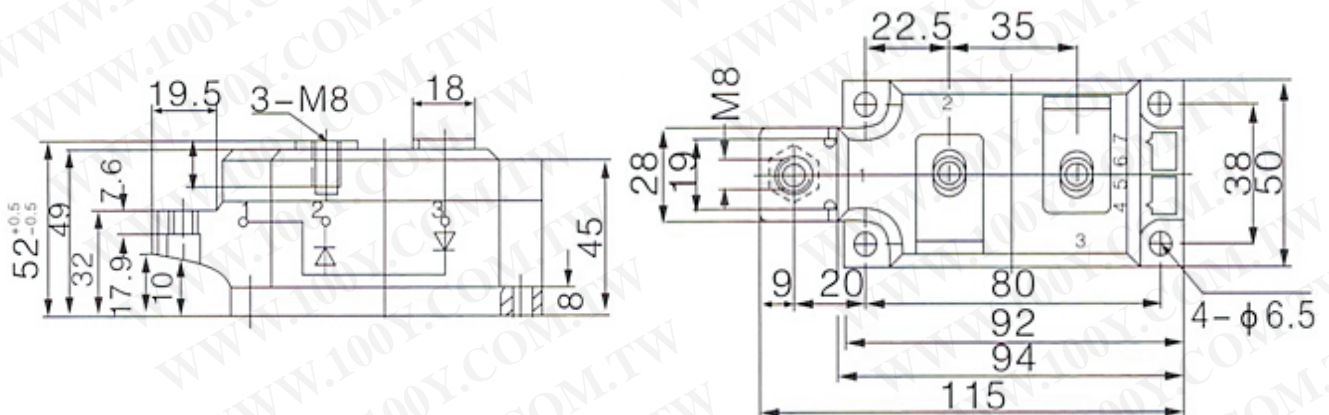


Fig. 6 Transient thermal impedance vs. time

外形尺寸图



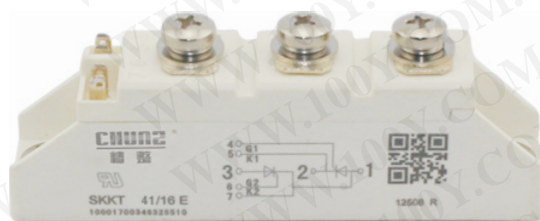
特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{T(AV)}$	48A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	1000A
I_{T^2t}	$1.5A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			48	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			110	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			10	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			10	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I_{T^2t}	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$	125			550	$A^2s \times 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			9	V
r_T	斜率电阻		125			12	m Ω
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=480A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			1000	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=320A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$ 门极上升时间 $t_{ir} \leq 0.5 \mu s$	125			150	A/ μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	3		150	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	100		200	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	25			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图

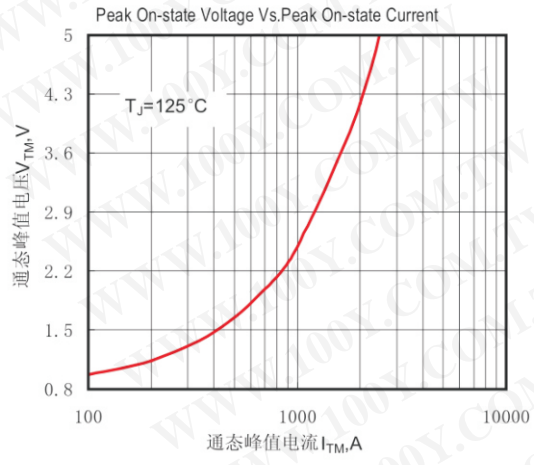


Fig.1 通态伏安特性曲线

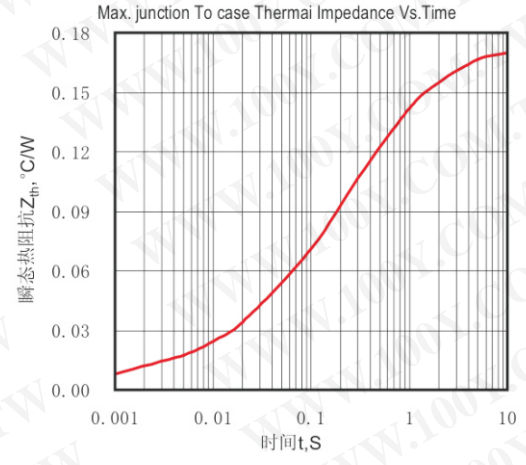


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

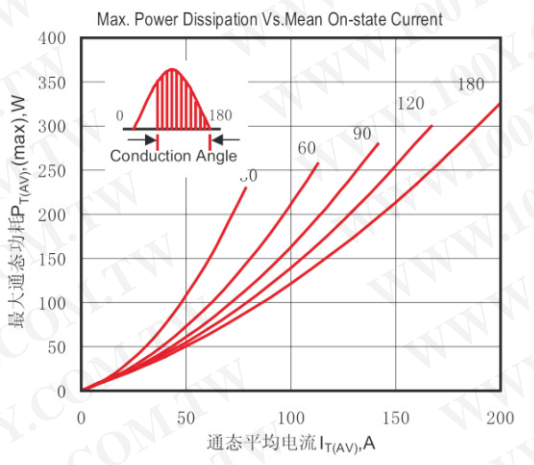


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

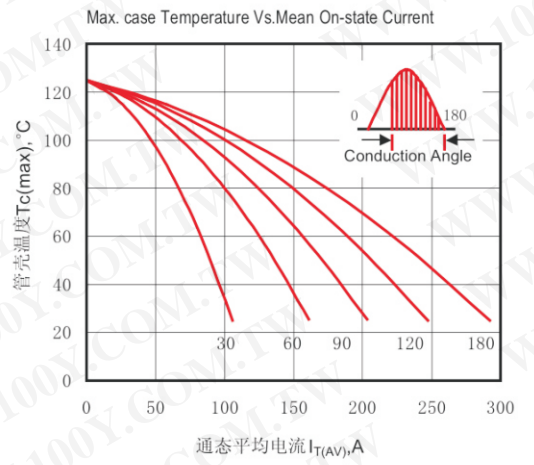


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

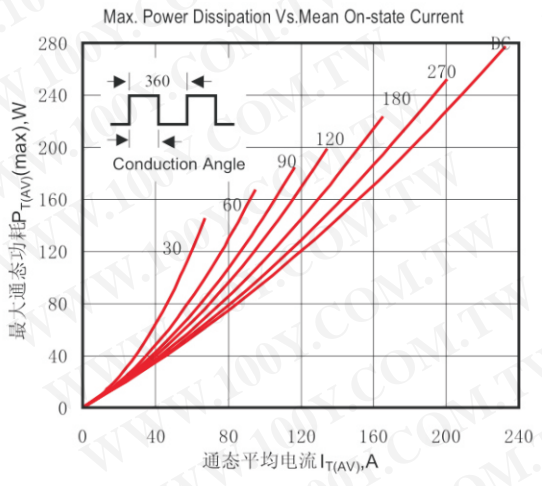


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

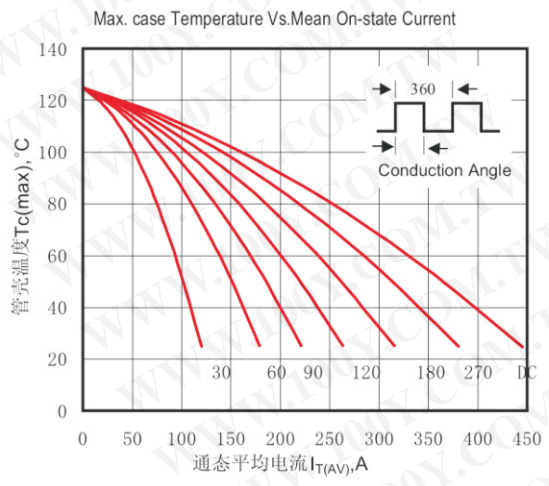


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

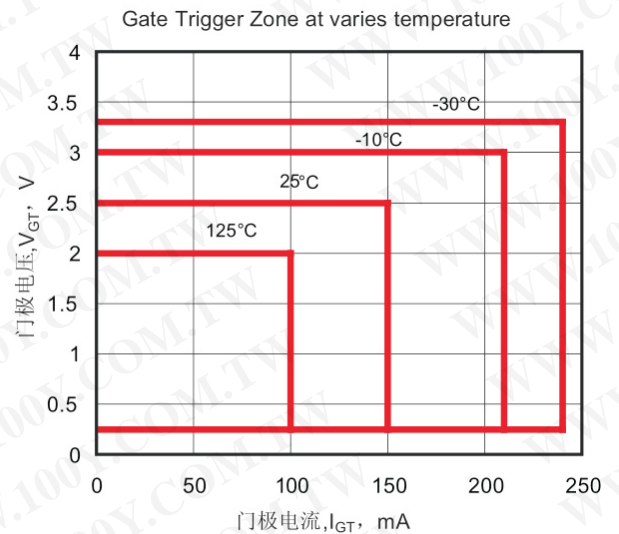
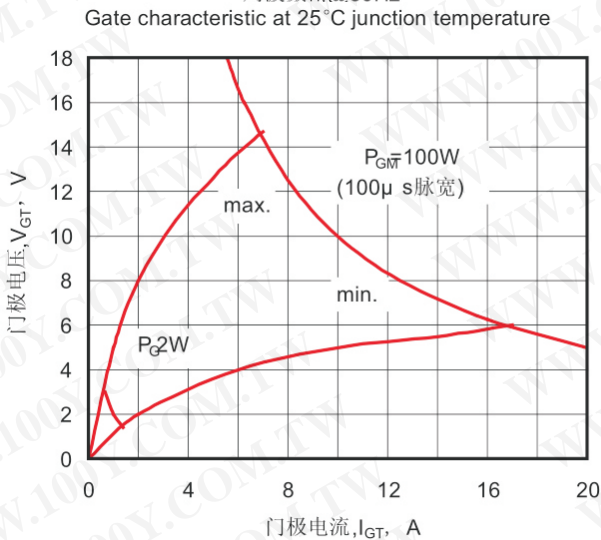
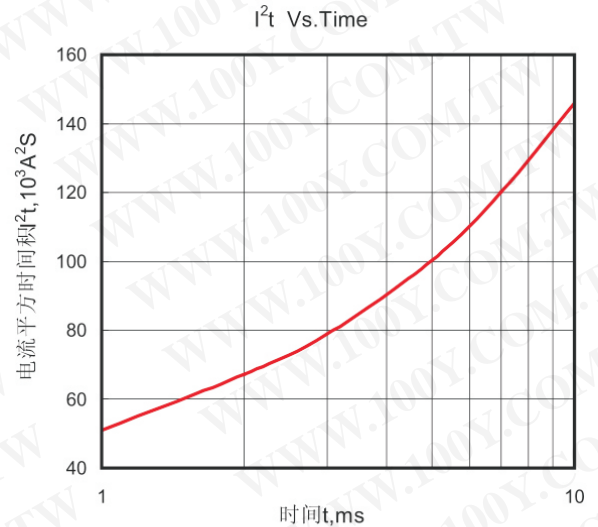
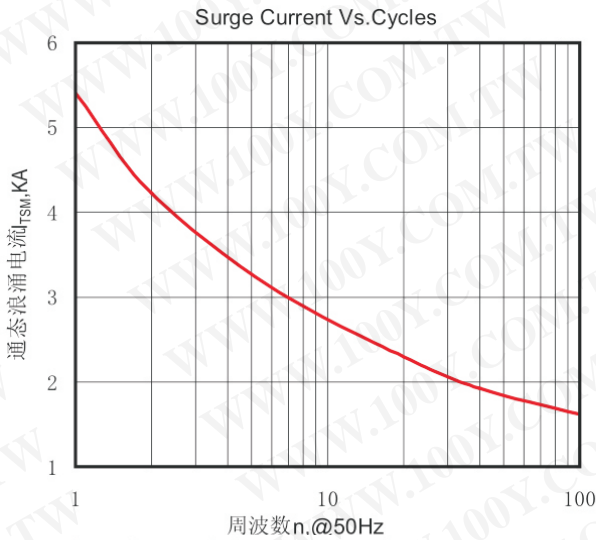
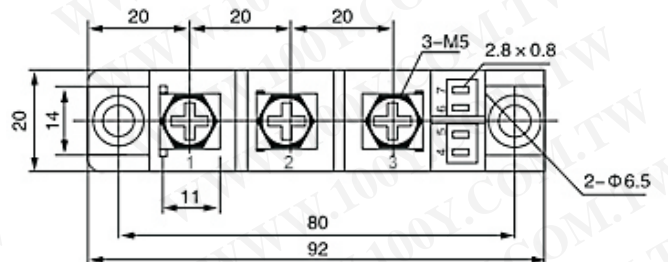
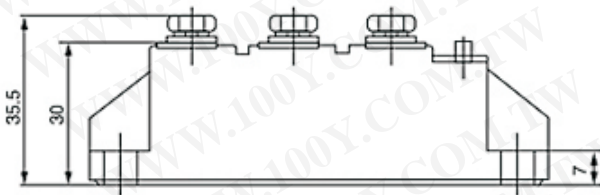


Fig.9 门极功率曲线

Fig.10 门极触发特性曲线

外形尺寸图



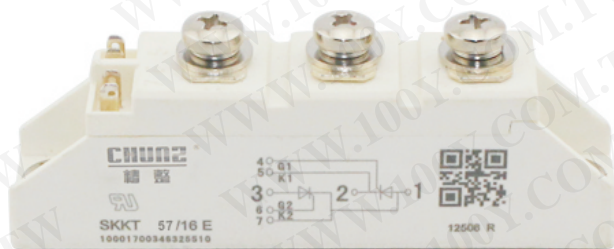
特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{T(AV)}$	57A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	1000A
I_{T^2t}	$1.5A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			57	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			110	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			10	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			10	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I_{T^2t}	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$	125			550	$A^2s \times 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			9	V
r_T	斜率电阻		125			12	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=480A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			1000	V/μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=320A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$ 门极上升时间 $t_{ir} \leq 0.5 \mu s$	125			150	A/μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	3		150	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	100		200	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	25			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图

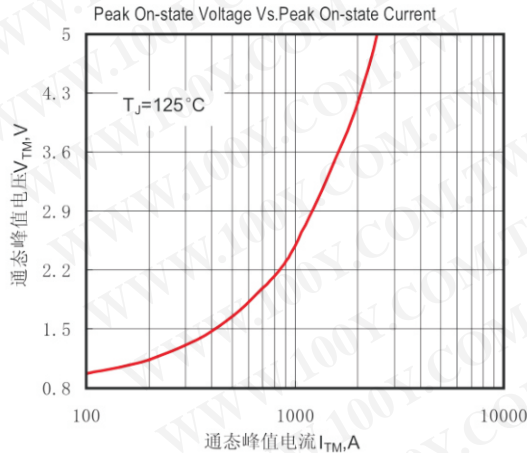


Fig.1 通态伏安特性曲线

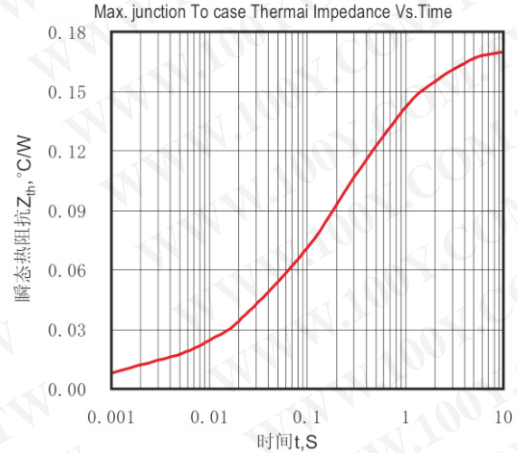


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

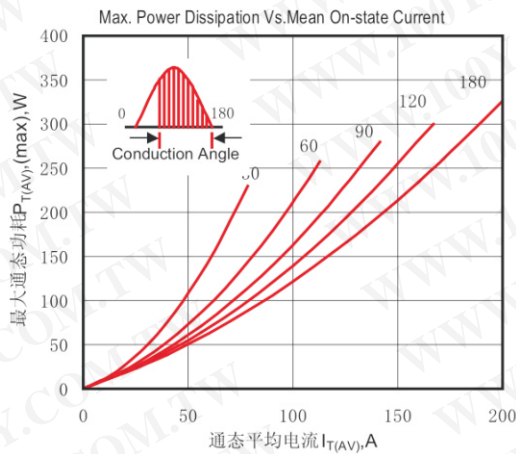


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

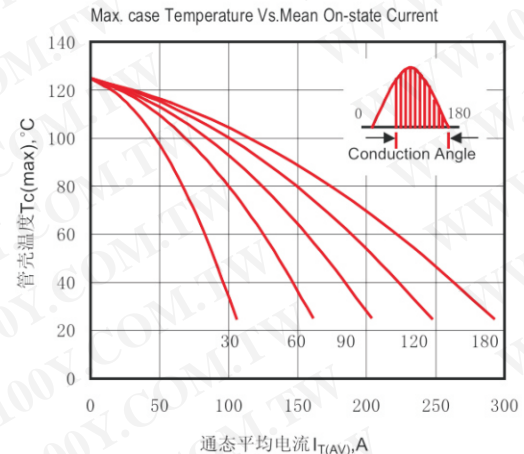


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

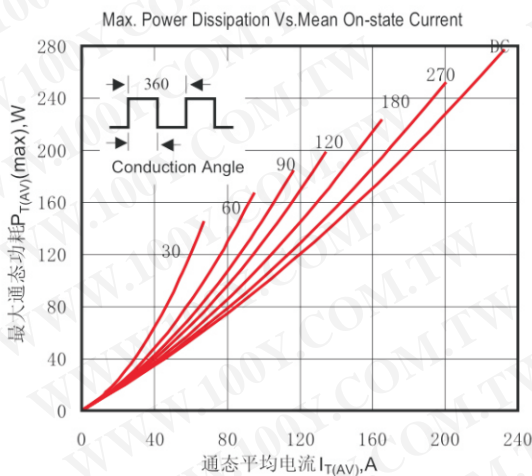


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

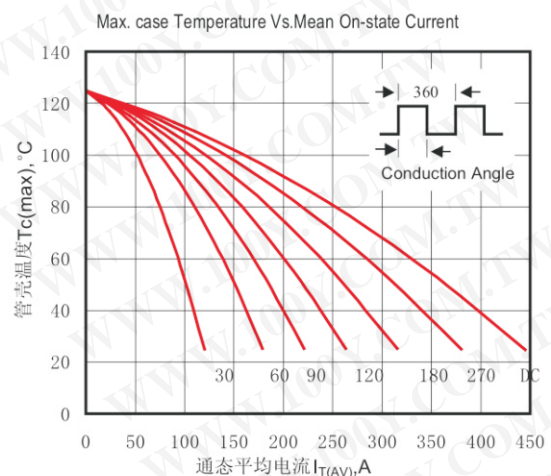


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

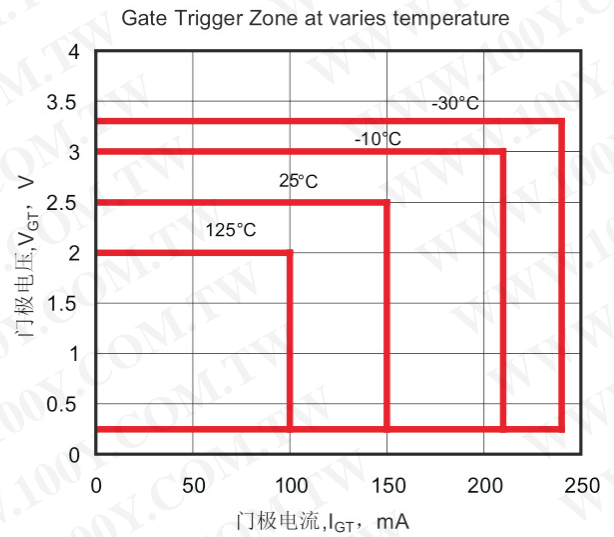
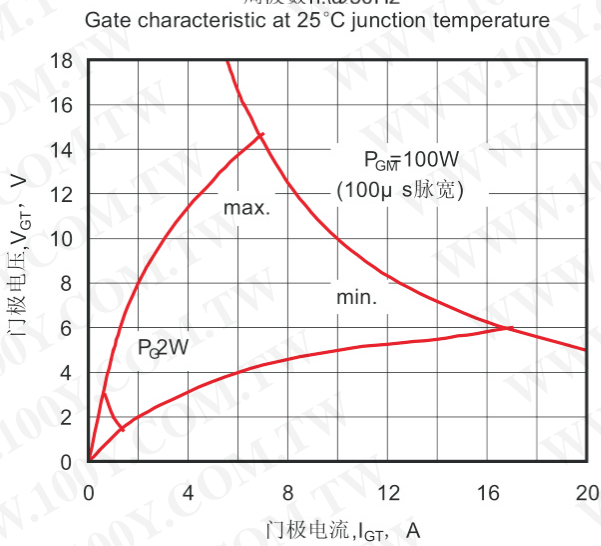
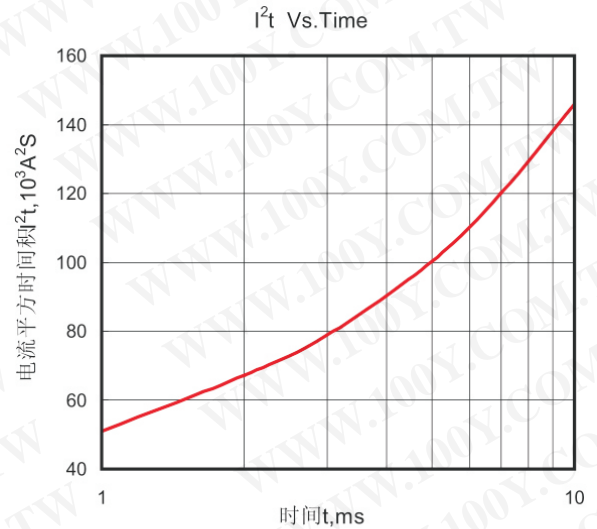
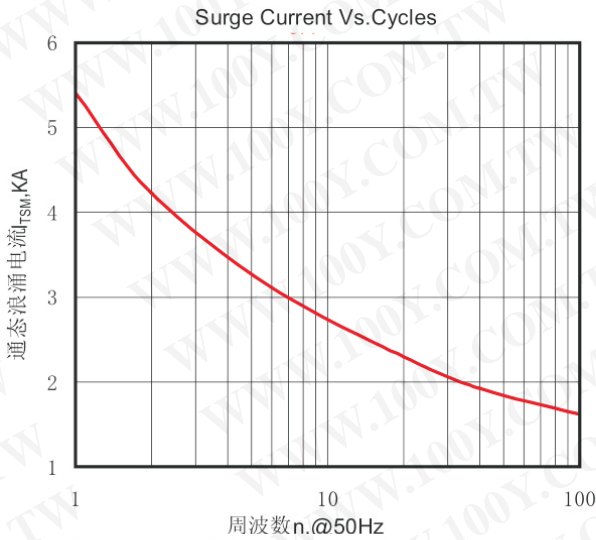
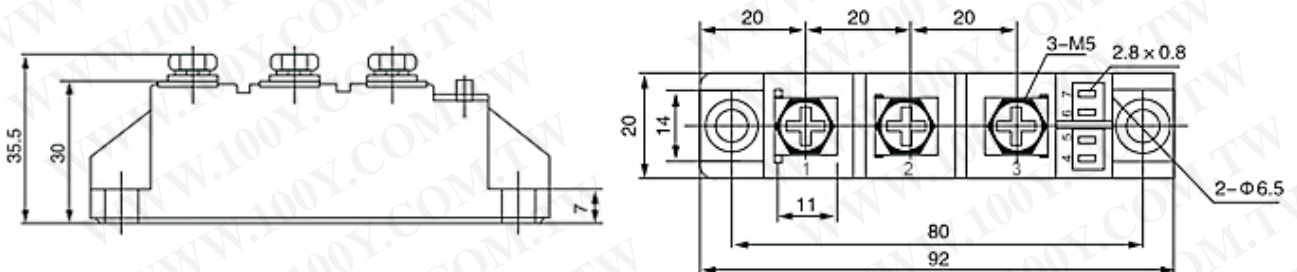


Fig.9 门极功率曲线

Fig.10 门极触发特性曲线

外形尺寸图



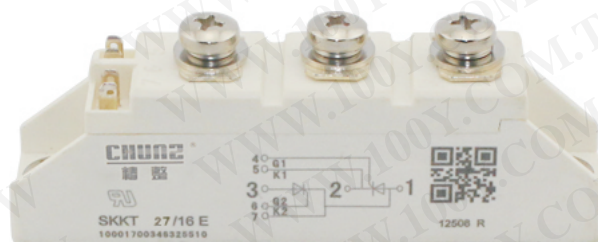
特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{T(AV)}$	72A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	1000A
I_{T^2t}	$1.5A^2S \times 10^3$



主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			72	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			110	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			10	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			10	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I_{T^2t}	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$	125			550	$A^2s \times 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			9	V
r_T	斜率电阻		125			12	m Ω
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=480A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			1000	V/ μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=320A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$ 门极上升时间 $t_{ir} \leq 0.5 \mu s$	125			150	A/ μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	3		150	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	100		200	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	25			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图

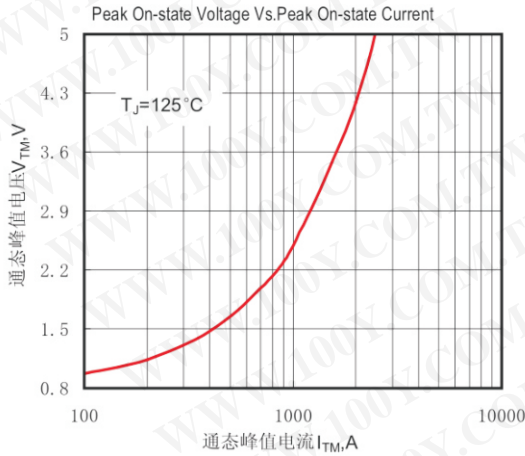


Fig.1 通态伏安特性曲线

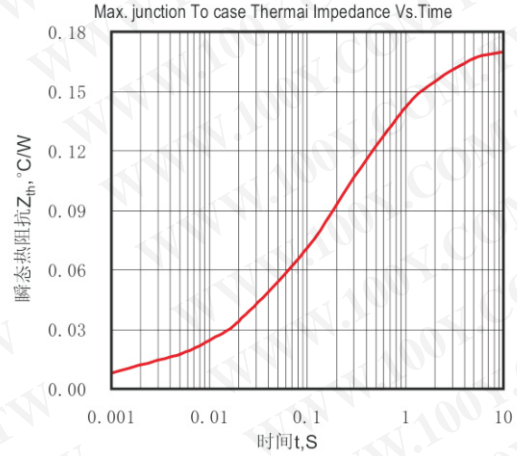


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

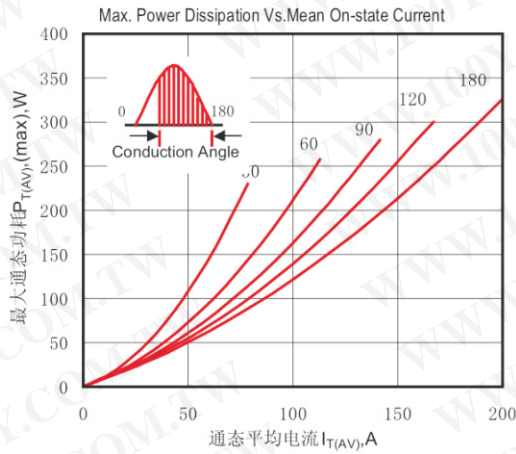


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

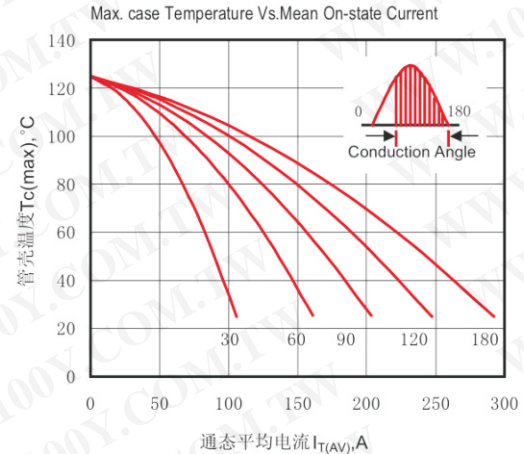


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

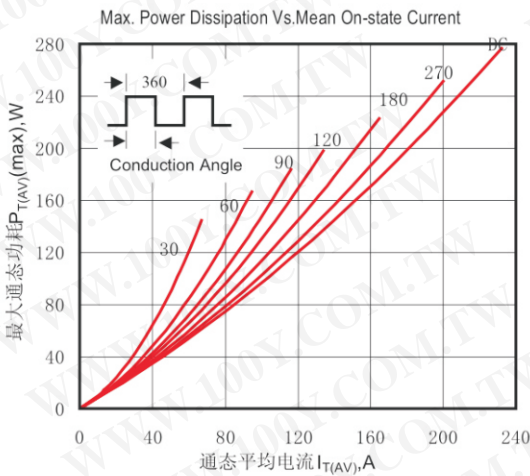


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

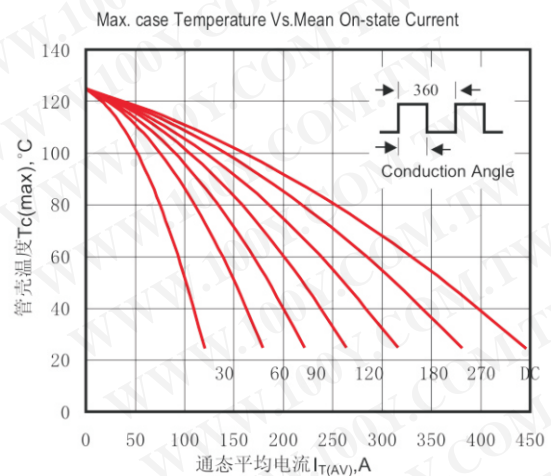


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

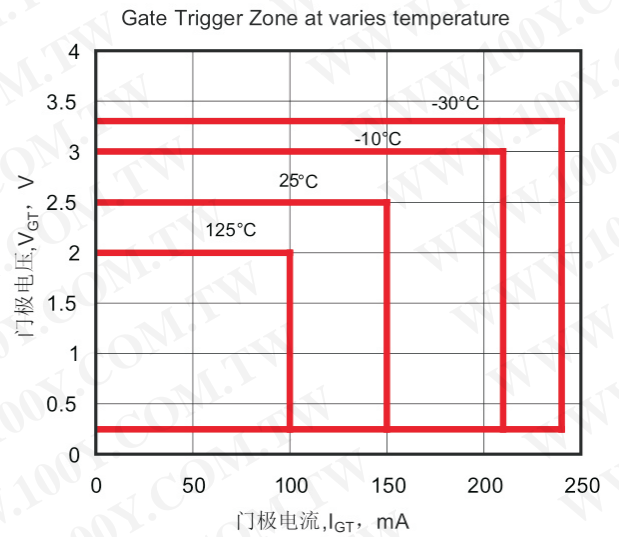
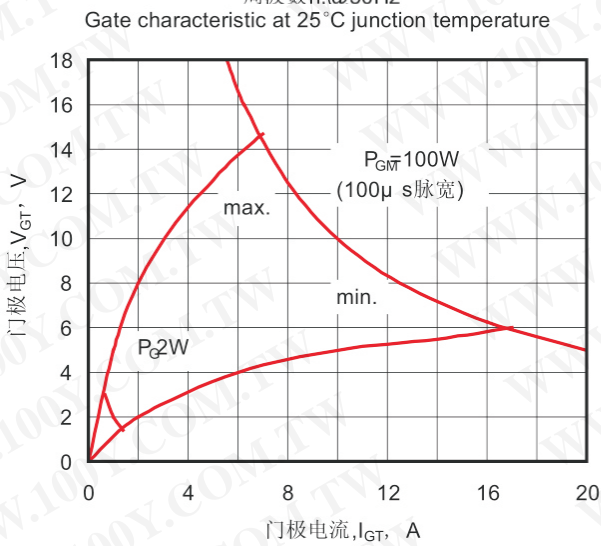
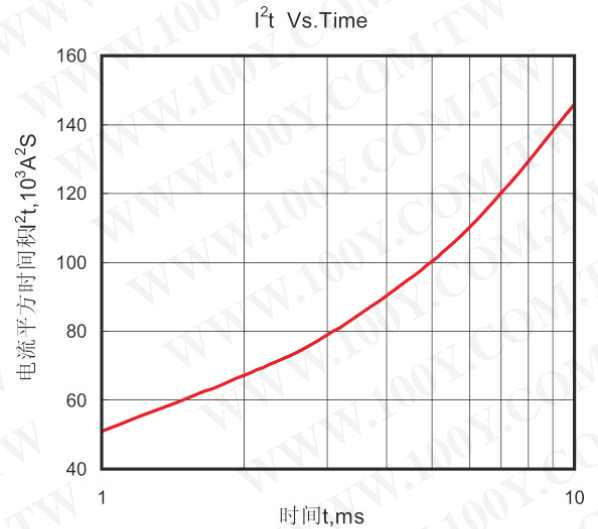
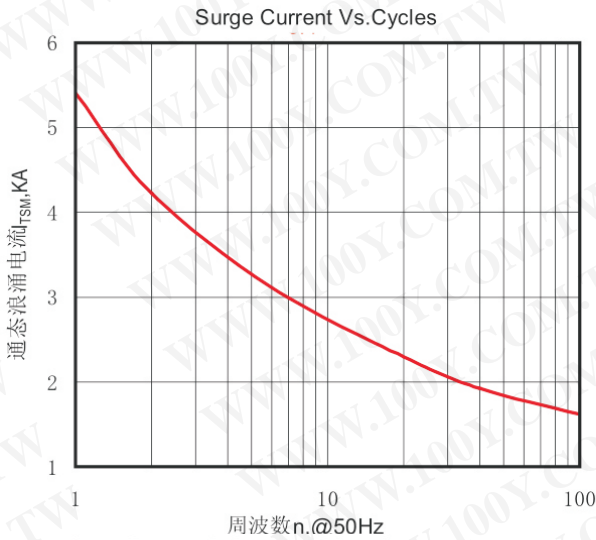
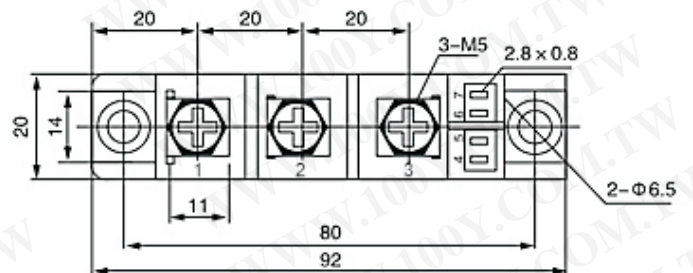
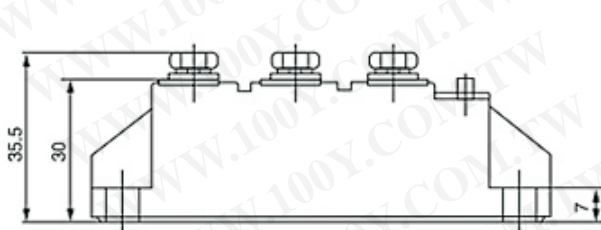


Fig.9 门极功率曲线

Fig.10 门极触发特性曲线

外形尺寸图



特点

1. 芯片与底板电气绝缘, 2500V交流电压
2. 全压接结构, 优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制
2. 各种整流电源
3. 变频器

$I_{T(AV)}$	92A
V_{DRM}/V_{RRM}	1600V
I_{TSM}	1000A
I_{T^2t}	$1.5A^2S \cdot 10^3$

主要参数

符号	参数	测试条件	结温			单位	
			$T_j(^{\circ}C)$	最小	典型		最大
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50Hz单面散热, $T_c=85^{\circ}C$	125			92	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			110	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \ t_p=10ms$	125		1600		V
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM} +200V$	125		1600		V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			10	mA
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	125			10	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 正弦半波	125			8.50	KA
I_{T^2t}	浪涌电流平方时间积	$V_r=0.6V_{RRM}$	125			550	$A^2s \cdot 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			9	V
r_T	斜率电阻		125			12	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=480A$	25			1.57	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$	125			1000	V/μs
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{TM}=320A$, 门极触发电流幅值 $I_{GM}=1.5A$ 门极上升时间 $t_{ir} \leq 0.5 \mu s$	125			150	A/μs
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	3		150	mA
V_{GT}	门极触发电压	$V_A=12V, I_A=1A$	25	0.8		2.5	V
I_H	维持电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	100		200	mA
V_{GD}	门极不触发电压	At 67% V_{DRM}	125	25			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.130	$^{\circ}C /W$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.04	$^{\circ}C /W$
T_{stg}	贮存温度			-40		125	

性能曲线图

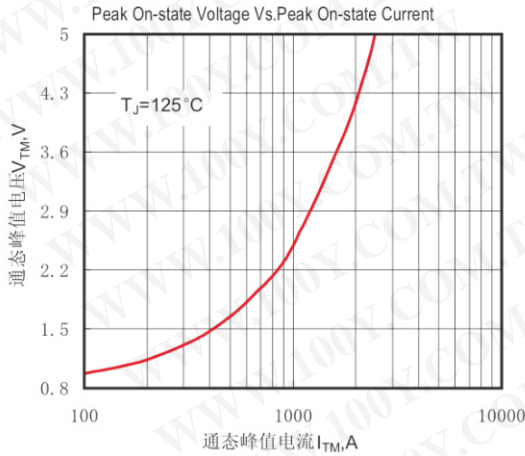


Fig.1 通态伏安特性曲线

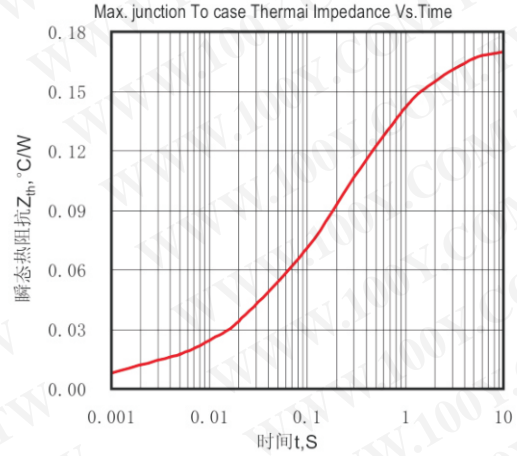


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

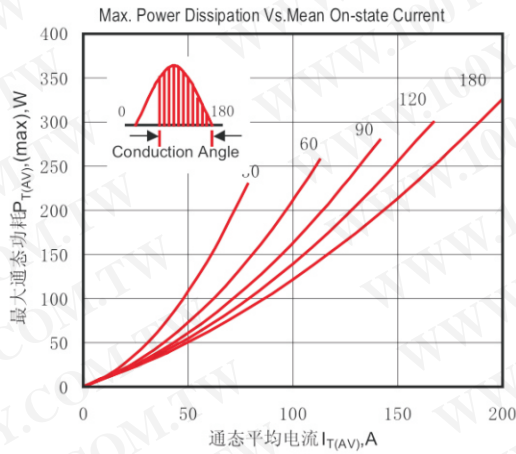


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

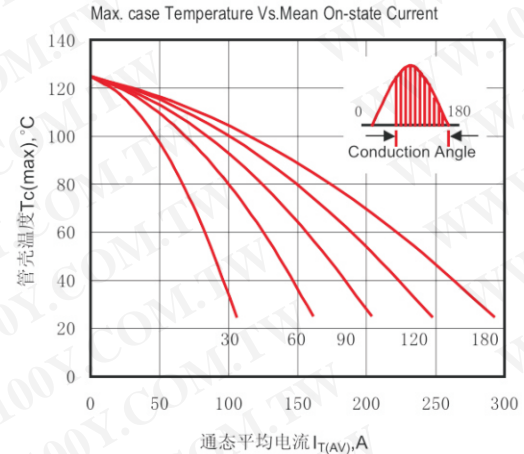


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

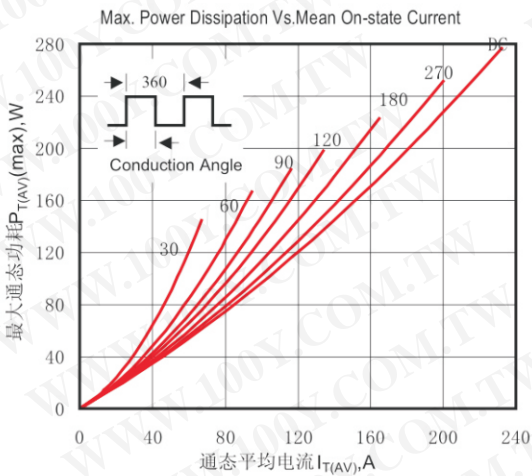


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

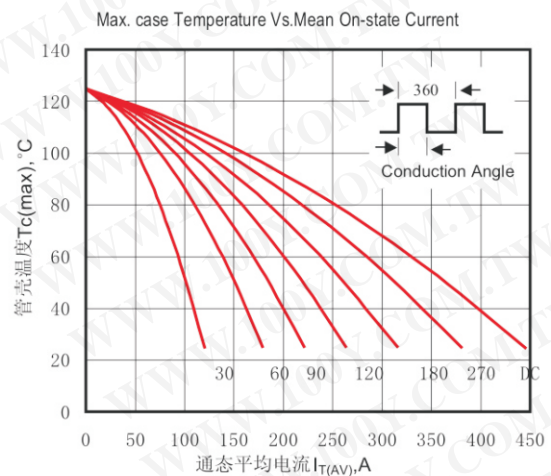


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

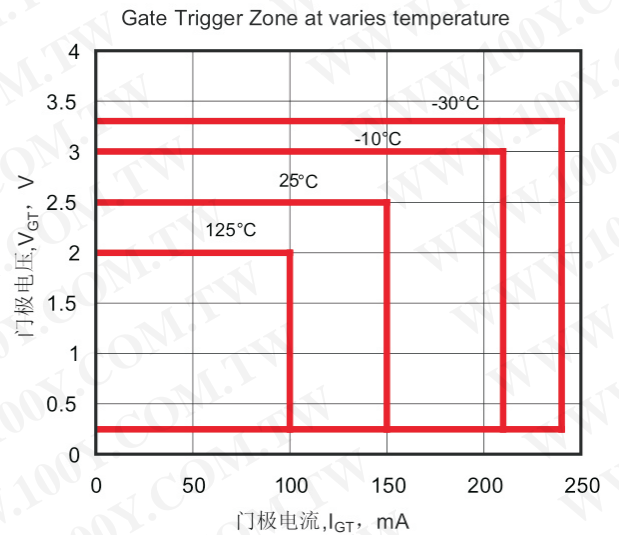
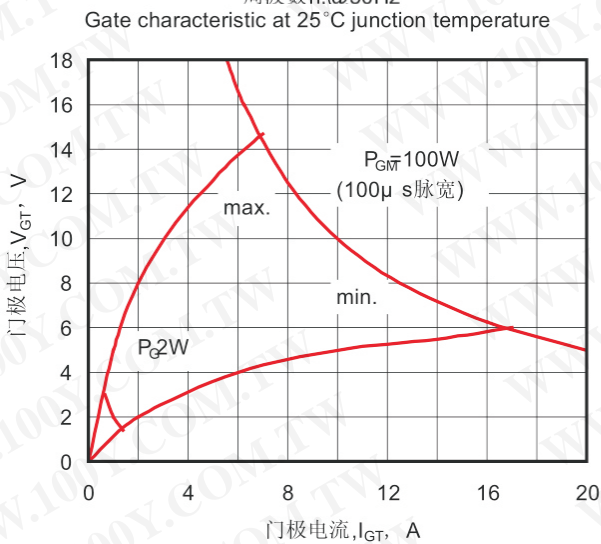
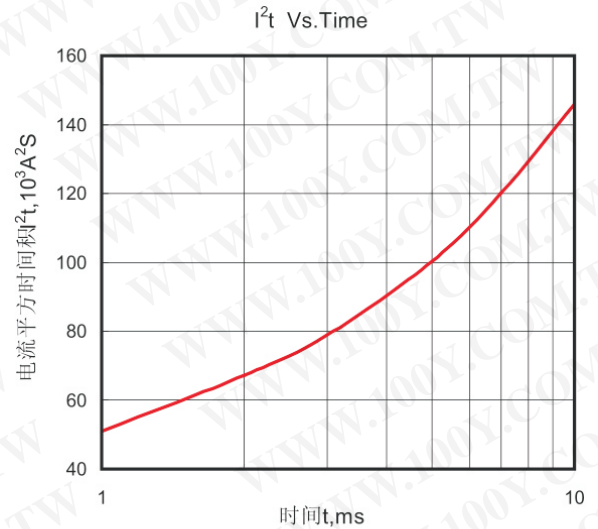
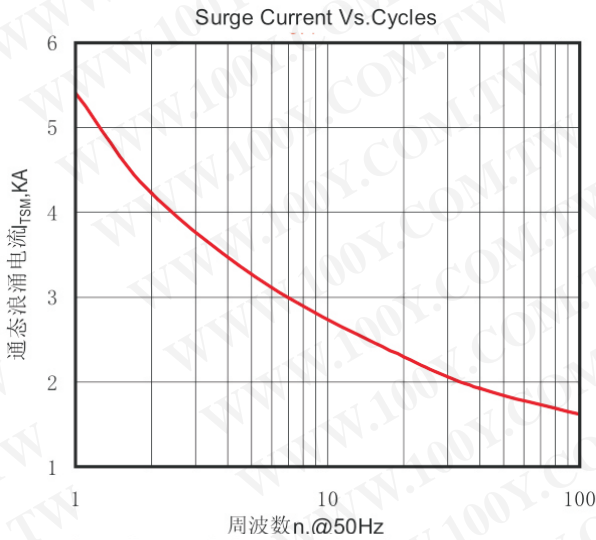


Fig.9 门极功率曲线

Fig.10 门极触发特性曲线

外形尺寸图

